

Aluminium nitride sintered body, metal embedded article, electronic functional material and electrostatic chuck

Patent Number: ☐ EP0798278, A3, B1

Publication date: 1997-10-01

Inventor(s): MORI YUKIMASA (JP); KATSUDA YUJI (JP); TAKAHASHI MICHIO (JP); BESSHO YUKI (US)

Applicant(s): NGK INSULATORS LTD (JP)

Requested Patent: ☐ JP9315867

Application Number: EP19970302083 19970326

Priority Number(s): JP19960099557 19960329; JP19970072799 19970311

IPC Classification: C04B35/581

EC Classification: C04B35/581, H01L21/68E

Equivalents: DE69706734D, DE69706734T, KR268481, ☐ US6001760

Abstract

In AlN crystal grains constituting a sintered body, is contained: 150 ppm - 0.5 wt.%, preferably at most 0.1 wt.%, of at least one rare earth element (as oxide thereof); at most 900 ppm, preferably at most 500 ppm of at least one metal impurity except rare earth elements; and preferably at least 0.5 wt.% of oxygen measured by an electron probe X-ray microanalyzer. The grains have an average grain diameter of preferably at least 3.0 μm and show a main peak in the wavelength range of 350 - 370 nm of spectrum obtained by a cathode luminescence method. The sintered body composed of AlN crystal grains has a volume resistivity at room temperature of at most 1.0×10^{12} $\Omega\cdot\text{cm}$.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-315867

(43)公開日 平成9年(1997)12月9日

(51)Int.Cl.
C04B 35/581
H01L 21/68

識別記号

F I
C04B 35/58 104 B
H01L 21/68 R

審査請求 未請求 請求項の数33 F D (全29頁)

(21)出願番号 特願平9-72799
(22)出願日 平成9年(1997)3月11日
(31)優先権主張番号 特願平8-99557
(32)優先日 平8(1996)3月29日
(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000004064
日本碍子株式会社
愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号
(72)発明者 勝田 祐司
愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日
本碍子株式会社内
(72)発明者 森 行正
愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日
本碍子株式会社内
(72)発明者 別所 裕樹
アメリカ合衆国 カリフォルニア州サンノ
ゼ市フォレストグレン通り 5145番地
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外9名)

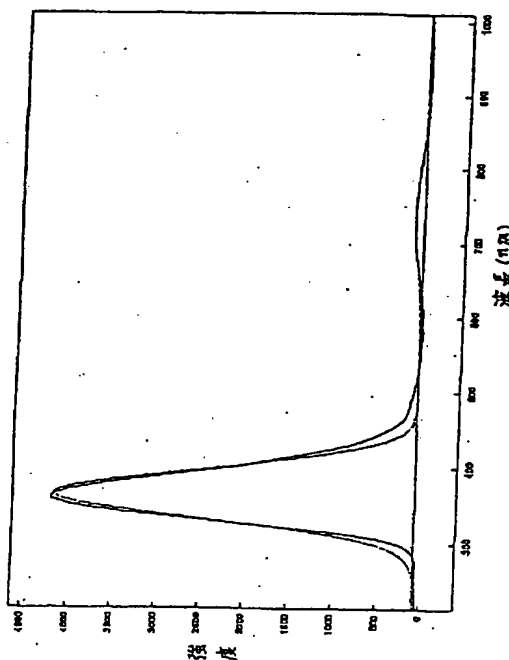
最終頁に続く

(54)【発明の名称】窒化アルミニウム焼結体、金属埋設品、電子機能材料および静電チャック

(57)【要約】

【課題】高純度であって、かつ低い体積抵抗率を有する、新規な窒化アルミニウム焼結体を提供すること

【解決手段】窒化アルミニウム結晶粒子中の希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が150ppm以上、0.5重量%以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が900ppm以下であり、カソードルミネッセンスによるスペクトルにおいて、350nm~370nmの波長領域に主要ピークを有している。体積抵抗率が $1 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下である。好ましくは、窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径が3.0 μm 以上であり、希土類元素の含有量が0.1重量%以下であり、金属不純物量が500ppm以下であり、またX線マイクロアナライザーによる各窒化アルミニウム結晶粒子の酸素濃度が0.5重量%以上である。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】希土類元素の含有量（酸化物への換算値）が 150 ppm 以上、0.5 重量% 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900 ppm 以下であり、カソードルミネッセンスによるスペクトルにおいて、350 nm ~ 370 nm の波長領域に主要ピークを有していることを特徴とする、窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 2】前記窒化アルミニウム焼結体を構成する窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径が 3.0 μm 以上であることを特徴とする、請求項 1 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 3】前記窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径が 5 μm 以上、20 μm 以下であることを特徴とする、請求項 2 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 4】希土類元素の含有量が 0.1 重量% 以下であることを特徴とする、請求項 1 ~ 3 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 5】前記金属不純物量が 500 ppm 以下であることを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 6】前記カソードルミネッセンスによるスペクトルにおいて、前記主要ピークが前記窒化アルミニウム焼結体を構成する前記窒化アルミニウム結晶粒子内から発生していることを特徴とする、請求項 1 ~ 5 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 7】前記窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率が $1.0 \times 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上、 $1.0 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることを特徴とする、請求項 1 ~ 6 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 8】前記窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率が $1.0 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることを特徴とする、請求項 7 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 9】前記窒化アルミニウム焼結体の相対密度が 98.5 % 以上であることを特徴とする、請求項 1 ~ 8 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 10】前記窒化アルミニウム焼結体中の全酸素量と、前記希土類元素を酸化物換算した場合の含有酸素量との差が 0.5 重量% 以上、2.0 重量% 以下であることを特徴とする、請求項 1 ~ 9 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 11】X線マイクロアナライザーによって測定した前記窒化アルミニウム結晶粒子中の酸素濃度が 0.50 重量% 以上、2.00 重量% 以下であることを特徴とする、請求項 1 または 10 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 12】前記希土類元素が前記窒化アルミニウム結晶粒子中に実質的に存在せず、隣接する二つの前記窒化アルミニウム結晶粒子の界面に存在していることを特徴とする、請求項 10 または 11 記載の窒化アルミニウム

ム焼結体。

【請求項 13】前記希土類元素が、隣接する二つの前記窒化アルミニウム結晶粒子の界面で結晶相を形成していないことを特徴とする、請求項 12 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 14】隣接する二つの前記窒化アルミニウム結晶粒子の粒界において、各窒化アルミニウム結晶粒子を構成する結晶格子が乱れている部分の幅が 1 nm 以下であることを特徴とする、請求項 12 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 15】前記窒化アルミニウム焼結体中の三重点の結晶相に、希土類元素が実質的に含有されておらず、前記三重点に面する各結晶粒子の表面または表面近傍に希土類元素が存在していることを特徴とする、請求項 12 ~ 14 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 16】電子スピン共鳴法によるスペクトルのアルミニウムの不対電子の g 値が 2.000 以下であることを特徴とする、請求項 1 または 12 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 17】電子スピン共鳴法によるスペクトルから得られたアルミニウムの単位 mg 当たりのスピン数が $1 \times 10^{11} \text{ spin/mg}$ 以上であることを特徴とする、請求項 1、12 または 16 記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 18】バルク状の焼結体であることを特徴とする、請求項 1 ~ 17 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 19】請求項 18 記載の窒化アルミニウム焼結体と、この窒化アルミニウム焼結体中に埋設されている金属部材とを備えていることを特徴とする、金属埋設品。

【請求項 20】請求項 1 ~ 18 のいずれか一つの請求項に記載の窒化アルミニウム焼結体からなる電子機能材料。

【請求項 21】半導体を吸着し、保持するための吸着面を備えた静電チャックであって、請求項 18 記載の窒化アルミニウム焼結体からなる基体と、この基体中に埋設された面状の電極と、この面状の電極に対して直流電力を供給するための電源とを備えていることを特徴とする、静電チャック。

【請求項 22】希土類元素の含有量（酸化物への換算値）が 150 ppm 以上、0.5 重量% 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900 ppm 以下である窒化アルミニウム焼結体であって、X線マイクロアナライザーによって測定した、前記窒化アルミニウム焼結体を構成する窒化アルミニウム結晶粒子中の酸素濃度が 0.50 重量% 以上、2.00 重量% 以下であることを特徴とする、窒化アルミニウム焼結体。

【請求項 23】請求項 22 記載の窒化アルミニウム焼結

10

20

30

40

50

体と、この窒化アルミニウム焼結体中に埋設されている金属部材とを備えていることを特徴とする、金属埋設品。

【請求項24】請求項22記載の窒化アルミニウム焼結体からなる電子機能材料。

【請求項25】希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が150ppm以上、0.5重量%以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が900ppm以下である窒化アルミニウム焼結体であって、この窒化アルミニウム焼結体の電子スピン共鳴法によるスペクトルにおいて、不対電子のg値が2.000以下であることを特徴とする、窒化アルミニウム焼結体。

【請求項26】請求項25記載の窒化アルミニウム焼結体と、この窒化アルミニウム焼結体中に埋設されている金属部材とを備えていることを特徴とする、金属埋設品。

【請求項27】請求項25記載の窒化アルミニウム焼結体からなる電子機能材料。

【請求項28】希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が150ppm以上、0.5重量%以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が900ppm以下である窒化アルミニウム焼結体であって、電子スピン共鳴法によるスペクトルから得られたアルミニウムの単位mg当たりのスピン数が 1×10^{17} spin/mg以上であることを特徴とする、窒化アルミニウム焼結体。

【請求項29】請求項28記載の窒化アルミニウム焼結体と、この窒化アルミニウム焼結体中に埋設されている金属部材とを備えていることを特徴とする、金属埋設品。

【請求項30】請求項28記載の窒化アルミニウム焼結体からなる電子機能材料。

【請求項31】希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が150ppm以上、0.5重量%以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が900ppm以下である窒化アルミニウム焼結体であって、この窒化アルミニウム焼結体を構成する窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径が $3.0 \mu\text{m}$ 以上であり、前記窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率が $1.0 \times 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上、 $1.0 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることを特徴とする、窒化アルミニウム焼結体。

【請求項32】請求項31記載の窒化アルミニウム焼結体と、この窒化アルミニウム焼結体中に埋設されている金属部材とを備えていることを特徴とする、金属埋設品。

【請求項33】請求項31記載の窒化アルミニウム焼結体からなる電子機能材料。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、高純度で低い体積抵抗率を有する新規な窒化アルミニウム焼結体に関するもの

であり、また、この窒化アルミニウム焼結体を利用した金属埋設品、電子機能材料および静電チャックに関するものである。

【0002】

【従来の技術】現在、半導体ウエハーの搬送、露光、CVD、スパッタリング等の成膜プロセス、微細加工、洗浄、エッチング、ダイシング等の工程において、半導体ウエハーを吸着し、保持するために、静電チャックが使用されている。こうした静電チャックの基体として、緻密なセラミックスが注目されている。特に半導体製造装置においては、エッチングガスやクリーニングガスとして、 ClF_3 等のハロゲン系腐食性ガスを多用する。また、半導体ウエハーを保持しつつ、急速に加熱し、冷却させるためには、静電チャックの基体が高い熱伝導性を備えていることが望まれる。また、急激な温度変化によって破壊しないような耐熱衝撃性を備えていることが望まれる。緻密な窒化アルミニウムは、前記のようなハロゲン系腐食性ガスに対して高い耐食性を備えている。また、こうした窒化アルミニウムは、高熱伝導性材料として知られており、その体積抵抗率が室温で $10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上であることも知られている。また、耐熱衝撃性も高いことが知られている。従って、半導体製造装置用の静電チャックの基体を窒化アルミニウム焼結体によって形成することが好適であると考えられる。

【0003】一方、半導体製造装置において、半導体ウエハーを保持するサセプターとして静電チャックを使用するためには、静電チャックの吸着力を高める必要があり、このために基体の固有抵抗を減少させる必要がある。例えば、特公平7-19831号公報においては、静電チャックの絶縁性誘電層の抵抗値を減少させて静電チャックの吸着力を向上させるために、体積固有抵抗の高い絶縁性材質に対して導体あるいは半導体を混合することによって、その体積抵抗率を $10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下に制御している。また、特開平2-22166号公報においては、アルミナを主成分とするセラミックス原料を還元雰囲気下で焼成して静電チャック用の誘電体セラミックスを製造し、この際、原料中に、アルカリ土類金属および遷移金属を、酸化物の重量に換算して、それぞれ、1~6重量%、0.5~6重量%含有させた。この方法においては、例えば、アルミナセラミックス中に TiO_2 を混合することによって誘電率を向上させるのと共に、その体積抵抗率を $10^{11} \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ にまで低下させ、これによって高い吸着力を得ようとしている。しかし、こうした方法によると、アルカリ土類金属、遷移金属の腐食によって生じた生成物がパーティクルとなる等の問題が生ずる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかし、高純度の窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率は $10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上であるために、半導体製造装置用の静電チャックの基

体として用いるには、体積抵抗率が高い。これによって十分な吸着力を得るためには、 $300\mu\text{m}$ 以下の極めて薄い絶縁性誘電層を形成する必要がある。しかし、このように絶縁性誘電層が薄いと、ハロゲン系腐食性ガスやプラズマに接触したときに、長時間の使用中には、絶縁性誘電層の表面の反応物層のいずれかを起点として、絶縁破壊等が発生する可能性があることが判った。この観点からは、絶縁性誘電層の厚さを $500\mu\text{m}$ 以上とすることが好ましいことが判明してきた。

【0005】しかし、従来の窒化アルミニウム焼結体製の静電チャックにおいては、このように絶縁性誘電層を厚くすると、静電チャックの吸着力が低下し、特に体積抵抗率が高い低温領域においては、十分な吸着力を得ることが困難であった。特に、ドライエッチングのプロセスを実施するのは、 $-50^{\circ}\text{C}\sim-60^{\circ}\text{C}$ の低温であり、また高密度プラズマCVDプロセスを実施するのは 100°C 前後と比較的に低温であるが、これらの低温プロセスにおいては、所定の吸着力を安定して得ることは困難であった。

【0006】このため、本発明者は、窒化アルミニウム焼結体自体について再検討した。

【0007】例えば、窒化アルミニウムを基体として使用した静電チャックにおいて、特公平7-19831号公報の記載に従って、窒化アルミニウム基体中に低抵抗材料を添加することを検討した。これによって、窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率を $10^{-1}\Omega\cdot\text{cm}$ 以下まで減少させることができた。しかし、この静電チャックでは、低抵抗材料である添加金属等が基体の表面から離脱し、半導体汚染の原因となる可能性がある。

【0008】また、イットリウム等の希土類元素の酸化物もしくは炭酸塩を、窒化アルミニウム原料中に焼結助剤として添加することによって、窒化アルミニウムの熱伝導率を向上させ、かつその緻密性を向上させることが提案されている(特公昭63-46032号公報)。こうした焼結助剤を使用すれば、常圧焼結法によっても緻密質の窒化アルミニウム焼結体を製造できる。しかし、このような窒化アルミニウム焼結体は体積抵抗率が高く、相対密度が99%程度のものであっても、その体積抵抗率は $10^{-1}\sim 10^1\Omega\cdot\text{cm}$ のレベルであった。

【0009】本発明の課題は、高純度であって、かつ低い体積抵抗率を有する、新規な窒化アルミニウム焼結体を提供することである。

【0010】また、本発明の課題は、こうした窒化アルミニウム焼結体からなる、半導体レベルの体積抵抗率を有する新規な電子機能材料を提供し、かつこの窒化アルミニウム焼結体を使用した静電チャックを提供することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明に係る窒化アルミニウム焼結体は、希土類元素の含有量(酸化物への換算

値)が 150ppm 以上、 $0.5\text{重量}\%$ 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900ppm 以下であり、カソードルミネッセンスによるスペクトルにおいて、 $350\text{nm}\sim 370\text{nm}$ の波長領域に主要ピークを有していることを特徴とする。

【0012】また、本発明に係る窒化アルミニウム焼結体は、希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が 150ppm 以上、 $0.5\text{重量}\%$ 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900ppm 以下であり、X線マイクロアナライザーによって測定した、窒化アルミニウム焼結体を構成する窒化アルミニウム結晶粒子中の酸素濃度が $0.50\text{重量}\%$ 以上、 $2.00\text{重量}\%$ 以下であることを特徴とする。

【0013】また、本発明に係る窒化アルミニウム焼結体は、希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が 150ppm 以上、 $0.5\text{重量}\%$ 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900ppm 以下であり、この窒化アルミニウム焼結体の電子スピン共鳴法によるスペクトルにおいて、不対電子のg値が 2.000 以下であることを特徴とする。

【0014】また、本発明に係る窒化アルミニウム焼結体は、希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が 150ppm 以上、 $0.5\text{重量}\%$ 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900ppm 以下である窒化アルミニウム焼結体であり、電子スピン共鳴法によるスペクトルから得られたアルミニウムの単位 mg 当たりのスピンの数が $1\times 10^1\text{spin}/\text{mg}$ 以上であることを特徴とする。

【0015】また、本発明の窒化アルミニウム焼結体は、希土類元素の含有量(酸化物への換算値)が 150ppm 以上、 $0.5\text{重量}\%$ 以下であり、希土類元素を除く金属不純物量が 900ppm 以下であり、窒化アルミニウム焼結体を構成する窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径が $3.0\mu\text{m}$ 以上であり、前記窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率が $1.0\times 10^1\Omega\cdot\text{cm}$ 以上、 $1.0\times 10^{-1}\Omega\cdot\text{cm}$ 以下であることを特徴とする。

【0016】また、本発明は、前記の窒化アルミニウム焼結体のいずれかと、この窒化アルミニウム焼結体中に埋設されている金属部材とを備えていることを特徴とする、金属埋設品に係るものである。また、前記の窒化アルミニウム焼結体からなる電子機能材料に係るものである。

【0017】また、本発明は、半導体を吸着し、保持するための吸着面を備えた静電チャックであって、前記の窒化アルミニウム焼結体からなる基体と、この基体中に埋設された面状の電極と、この面状の電極に対して直流電力を供給するための電源とを備えていることを特徴とする、静電チャックに係るものである。

【0018】本発明者は、希土類元素を除く金属不純物

量が 900 ppm 以下である窒化アルミニウム焼結体を製造するのに際して、この焼結体中の希土類元素の含有量（酸化物への換算値）を 0.5 重量% 以下に調整し、好ましくは窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径が 3.0 μm 以上となるように焼結を進行させることによって、驚くべきことに、体積抵抗率が $1 \times 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下である窒化アルミニウム焼結体を得ることに成功した。このような結果が得られた理由は明確ではないが、次のように推定できる。

【0019】基本的な考え方として、窒化アルミニウム焼結体の抵抗は、窒化アルミニウム結晶粒子の抵抗と、粒界の抵抗とを、直列および並列に接続している回路の抵抗値として、算出される。本発明者は、高純度の窒化アルミニウム粒子を使用し、これに少量の希土類元素化合物を添加し、ホットプレス法等の高い圧力を適用する方法によって、焼結体の緻密化を促進した。

【0020】この際、希土類元素の化合物の配合量が 0.5 重量% よりも大きいと、原料粒子中に存在する酸素が、焼成の過程で粒子の外部へと向かって拡散する。これに対して、本発明では、希土類元素化合物の配合量を少量に調整し、かつ焼結時に高圧を加えることによって、窒化アルミニウム結晶粒子中に酸素が固溶した状態で残留する。この結晶粒子中の酸素は、AlN の窒素原子を置換し、バンドギャップ内にドナー準位を形成し、粒子内の電子伝導性の向上をもたらす。このように、窒化アルミニウム結晶粒子中への酸素の固溶が、各結晶粒子の内部の抵抗を減少させるためには必須である。

【0021】従来、窒化アルミニウム焼結体中にイットリウム等の希土類元素の焼結助剤を添加する際には、酸化物換算値で数重量% 添加されている（特公昭 63-46032 号公報参照）。この添加量を積極的に減少させると、常圧焼結では緻密体を得られにくくなる。しかも、これらの焼結助剤の添加量を増加させることによって、窒化アルミニウム焼結体の熱伝導率を向上させるという研究が行われてきていた。つまり、窒化アルミニウム焼結体の気孔率を減少させ、熱伝導率を向上させるために、数重量% 程度の焼結助剤を添加することが常識であった。

【0022】また、窒化アルミニウムの原料粉末の粒子の内部には酸素が含有されており、焼結の過程で、焼結助剤の作用によって、各粒子の内部に存在していた酸素が粒子外へと拡散する。この酸素の窒化アルミニウム粒子からの排出のプロセスが進行するにつれて、熱伝導率が一層向上すると考えられてきた。

【0023】つまり、酸素原子は、窒化アルミニウム結晶粒子中に焼結後も残留する、一種の不純物と考えられており、焼結体の熱伝導率を向上させるために、粒子内の酸素の残留量を減少させるための研究がなされてきた。別の観点から見ると、窒化アルミニウム焼結体を半導体領域の体積抵抗率を有する材質として利用すると

研究は、これまでなされてこなかった。

【0024】これに対して、本発明においては、希土類元素化合物の配合量を調整し、焼結時の圧力を大きくすることによって、加圧焼結後の粒子内に残留する酸素の量を制御し、酸素を、各結晶粒子の内部抵抗を減少させるためのドナーとして残留させている。窒化アルミニウム焼結体の体積抵抗率を、半導体領域まで低下させるために、焼結後の結晶粒子中に残留する酸素をドナーとして使用するという概念は、まったく新しいものである。

【0025】窒化アルミニウム焼結体中の希土類元素の含有量は、酸化物に換算して 0.5 重量% 以下とする必要がある。これが 0.5 重量% を越えると、焼結過程において結晶粒子内の酸素が粒子の外部に拡散してしまう。このように酸素が排出され、粒子内部が純化されると、酸素の減少によるフォノン散乱の低減によって、熱伝導率は向上するが、各粒子の抵抗も上昇する。また、希土類元素が、各窒化アルミニウム結晶粒子の界面および三重点に残留し、粒界相を形成する。この粒界相によって、隣接する各窒化アルミニウム結晶粒子の界面付近の結晶格子が乱れ、結晶粒子間の密着性が損なわれる。こうした各結晶粒子の界面における乱れによって、これまで焼結体の体積抵抗率の下降が阻害されてきたものと考えられる。本発明の窒化アルミニウム焼結体においては、このような窒化アルミニウム結晶粒子の界面における原子配列の乱れさえもほとんど見られなくなった。

【0026】この観点から、希土類元素の含有量を 0.1 重量% 以下とすることによって、より一層焼結体の体積抵抗率が減少した。

【0027】また、焼結体中の希土類元素の含有量は、150 ppm 以上とする必要がある。これを 300 ppm 以上とすることによって、体積抵抗率の下降が特に顕著になることを発見した。この観点からは、焼結体中の希土類元素の含有量は、300 ppm 以上とすることが一層好ましい。

【0028】特に半導体プロセスに使用するためには、このプロセスの不純物と考えられるアルカリ金属、遷移金属は好ましくない。また、希土類を除く金属不純物は、粒内または粒界に存在し、粒内抵抗または粒界抵抗を上昇させる作用があるためと考えられる。

【0029】また、本発明においては高純度の原料を使用する必要があり、具体的には、希土類元素を除く金属不純物量を 900 ppm 以下とする必要があった。これが 900 ppm を越えると、やはり焼結体の体積抵抗率が上昇する傾向が見られた。この金属は、不純物として混入するものであるから、できる限り少ない方が好ましい。従って、希土類元素を除く金属不純物量を 500 ppm 以下とすることが好ましく、100 ppm 以下とすることが一層好ましく、0 ppm ないし検出限界以下である場合を含む。

【0030】また、焼結体中の窒化アルミニウム結晶粒

子の平均粒径は $3.0\mu\text{m}$ 以上とすることが好ましく、 $4.0\mu\text{m}$ 以上とすることが更に好ましく、 $5.0\mu\text{m}$ 以上とすることが一層好ましい。

【0031】前記結晶粒子の平均粒径が大きくなると、焼結体中での伝導パスにおける単位長さ当たりの結晶粒子の界面の数が減少する。一般に、結晶粒子中の抵抗よりも結晶粒子の界面における抵抗の方が大きく、例えば焼結温度を上げて粒成長させた場合、体積抵抗率が低下する傾向がある。粒子数に対する界面の数を少なくすることが、焼結体の体積抵抗率を減少させるために重要である。このため、結晶粒子の平均粒径が $3.0\mu\text{m}$ 未満までしか成長していないと、伝導パスにおける結晶粒子の界面の頻度が多いために、焼結体の抵抗が上昇する。

【0032】窒化アルミニウム結晶粒子の平均粒径の上限は特にはないが、一般的には $20\mu\text{m}$ 以下とすることが好ましい。

【0033】また、窒化アルミニウム焼結体の相対密度は、 98.5% 以上とすることが好ましく、これによって焼結体の体積抵抗率が一層低下する。この観点から、焼結体の相対密度を 99.0% 以上とすることが好ましく、 99.6% 以上とすることが、より一層好ましい。

【0034】このように、本発明においては、窒化アルミニウム焼結体を非常に緻密にすることが要請されるが、同時に、希土類元素化合物の配合量を小さくしており、実質的に希土類元素が焼結助剤としては作用しない程度の配合量としている。これと同時に、焼結を促進させる成分として作用可能な他の金属元素の配合量も、前記したように極力少なくする必要がある。こうした条件下では、常圧焼結法によっては、通常 90% 以下の相対密度しか得られない。

【0035】このため、本発明の窒化アルミニウム焼結体を得るためには、ホットプレス法、ホットアイソスタティックプレス法のような加圧焼結法を採用することが必要であり、これによって焼結助剤の必要性なしに窒化アルミニウム焼結体を緻密化させることができる。

【0036】このように、本発明の主要なポイントの一つは、焼成時に機械的圧力をも加えていることである。例えば、ホットプレス法は、従来の概念では、焼結体の緻密化を促進するための機械的圧力を加える方法として、把握されてきた。

【0037】しかし、本発明においては、単に窒化アルミニウム焼結体の緻密化を促進するというだけではない。即ち、焼成時の高温状態において、機械的圧力によって、窒化アルミニウム結晶粒子の電子状態ないしは粒界の電子状態が、窒化アルミニウム粒子の表面に焼成前から存在する少量の希土類元素とあいまって、常圧焼結では得られない干渉を受けている可能性がある。こうした干渉によって、隣接する結晶粒子の界面におけるアルミニウム原子および窒素原子の配列が制御され、界面における抵抗が減少しているものと考えられる。これによ

って、粒界の抵抗が下がっている可能性が高く、粒子内の抵抗も下げる効果があるかもしれない。

【0038】こうして得られた本発明の窒化アルミニウム焼結体は、驚くべきことに、 $1\times 10^{-1}\Omega\cdot\text{cm}$ の範囲内、更には $1\times 10^{-1}\Omega\cdot\text{cm}$ 以下、特には $1\times 10^{-1}\Omega\cdot\text{cm}$ 以下の体積抵抗率を有していた。こうした領域の体積抵抗率は、まさに半導体としての領域に属する。本発明は、金属不純物および希土類元素の混入の極めて少ない、純度の高い窒化アルミニウム焼結体において、こうした半導体領域の体積抵抗率を有する焼結体を初めて提供する点で画期的なものである。

【0039】なお、従来は、窒化アルミニウム焼結体は、高い熱伝導率を有する電気絶縁材料として研究されてきている。また、窒化アルミニウム焼結体中に電気伝導体や半導体をドーブすることによって、抵抗を減少させようとする試みはなされてきたが、本発明のように窒化アルミニウム結晶粒子自体の抵抗を減少させようとする研究はなされていない。

【0040】本発明者は、更に各結晶粒子の界面を調査し、焼結体の体積抵抗率が劇的に減少した理由を探索した。まず、前記したように希土類元素をまったく添加しない場合には、焼結体の体積抵抗率が本発明ほどは下降しなかったことと、結晶粒子中に希土類元素が固溶しないことから、隣接する結晶粒子の界面に微量の希土類元素が存在していると、結晶粒子間の界面における抵抗が減少するものと考えられる。

【0041】実際、本発明者は、後述する各測定法によって、希土類元素が窒化アルミニウム結晶粒子中に実質的に存在せず、隣接する二つの窒化アルミニウム結晶粒子の粒界に存在していることを発見した。ここで、希土類元素が結晶粒子中に実質的に存在しないとは、EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometer) によって希土類元素に該当するピークが存在しないことを言う。

【0042】この希土類元素は、隣接する二つの窒化アルミニウム結晶粒子の粒界に存在してはいるが、結晶相を形成してはならず、原子レベルで結晶粒子間の粒界に存在していることが判明した。そして、隣接する二つの窒化アルミニウム結晶粒子の粒界において、各窒化アルミニウム結晶粒子を構成する結晶格子が乱れている部分はほとんど見ることができず、この部分の幅が 5nm 以下であり、特には、 1nm 以下であることを発見した。測定した試料の中には、こうした界面における結晶格子の乱れが実質的に見られないものもあった。このような特異な結晶粒子の粒界の微構造によって、結晶粒子間の抵抗が著しく減少したものと考えられる。

【0043】また、本発明者は、窒化アルミニウム焼結体中の三重重点（三つの窒化アルミニウム結晶粒子によって形成される三重重点）を検討したが、三重重点の結晶相の内部には、希土類元素が実質的に含有されていないこと

が判明した。この結果から見て、希土類元素は、各窒化アルミニウム結晶粒子の表面近傍あるいは表面に、極めて薄いアモルファス相として存在しているものと考えられる。三重点においても、希土類元素は結晶粒子の表面近傍あるいは表面のみに存在していることが判明した。

【0044】これらの結果から、希土類元素以外の金属不純物が多い場合に、著しく体積抵抗率が上昇する理由も明らかである。こうした不純物金属原子は、窒化アルミニウム結晶粒子の内部に固溶し、または粒界に存在するが、こうした結晶粒子や粒界の抵抗値は高いものと考えられるからである。

【0045】また、窒化アルミニウム焼結体中の全酸素量から、希土類元素を酸化物として考えた場合の酸素量を差し引いた値を、0.5重量%以上とすることが好ましい。これは、窒化アルミニウム結晶粒子中に残留している酸素量を表している。これを0.5重量%以上とすることによって、結晶粒子それ自体の抵抗値を下げることで、焼結体全体の体積抵抗率も著しく減少する。ただし、この上限は2.0重量%である。

【0046】本発明者は、体積抵抗率の低い本発明の窒化アルミニウム焼結体について、結晶相内部や粒界の欠陥構造の構成を知るために、各試料について電子スピン共鳴法 (Electron spin resonance : ESR法) によるスペクトルをとった。この原理を簡単に説明する。不対電子は、磁場下では、ゼーマン効果によってエネルギー準位が分裂する。このエネルギー準位には、電子の軌道運動、近傍の原子の核磁気能率との相互作用が敏感に反応する。ESR法では、この分裂したエネルギー準位を測定することによって、不対電子を有する原子の近傍の原子および化学結合等に関する情報を知ることができ

る。

【0047】窒化アルミニウムにおいては、アルミニウムの不対電子の g 値が、不対電子の存在している結晶場によって変化する。この g 値は、理論的には自由電子では2.0000であり、相対論的補正で $g=2.002316$ の値をとる。窒化アルミニウム結晶相中のAl原子、N原子は、4配位のウルツァイト構造を有しており、アルミニウム原子と3つの窒素原子とによって sp^3 混成軌道を形成している。各試料の g 値から、格子欠陥中の不対電子が、どのような結晶配位に存在しているのか、どのような元素が不対電子の周辺に存在しているのかを、知ることができる。

【0048】この結果、本発明の窒化アルミニウム焼結体においては、電子スピン共鳴法によるスペクトルのアルミニウムの不対電子の g 値が2.000以下となることが判明した。

【0049】不対電子を有するAl原子に対して結合する原子の種類が変化すると、不対電子の g 値は大きく変化する。上記のように低い g 値が得られた原因は、こうしたアルミニウムと結合する原子の種類の変化に帰する

べきものである。4配位構造のSi原子において、これと同様な g 値の変化が生じていることが報告されている(「素材のESR評価法」アイビーシー出版第57頁参照)。これは、窒化アルミニウム結晶粒子中に残留する酸素原子の影響によるものと考えられる。

【0050】また、電子スピン共鳴法によるスペクトルから得られたアルミニウムの単位mg当たりのスピン数が 1×10^{11} spin以上であることも判明した。この測定方法は、「電子スピン共鳴」大矢 博昭、山内 淳著 (講談社刊) に記載された方法に従った。即ち、ESRスペクトルの吸収強度は、窒化アルミニウム結晶粒子中における不対電子の割合に比例している。 g 値の定量は、 g 値が既知の標準試料と比較して行う必要がある。即ち、 g 値が既知の試料と、本発明の窒化アルミニウム焼結体の試料とを、同じ条件下で測定し、得られた吸収曲線を積分曲線に直し、次に各積分曲線の各面積を比較する必要がある。

【0051】本発明者は、スピン数が既知のTEMPO L (4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル) 溶液を使用して、 Mn^{2+}/MgO の一本の超微細線を定量しておき、これを通してスピン数を比較し、ピークの面積比よりスピン数を算出した。

【0052】本発明者は、窒化アルミニウム焼結体の電気的特性に影響を及ぼすバンドギャップ内の電子状態を評価し、本発明の焼結体の特徴を更に明らかにするために、カソードルミネッセンススペクトルを測定した。

【0053】カソードルミネッセンスは、一般には、試料に対して電子線を照射したときの試料からの反射波の一種である。図1に模式図として示すように、励起電子が価電子帯から伝導帯へと励起されると、価電子帯に正孔が生ずる。価電子帯と正孔との間のバンドギャップに対応する発光が生ずる。これと共に、結晶内に含まれる欠陥や不純物の作用によって、伝導帯とは別に局在電子準位が生じている場合には、局在電子準位の励起電子と価電子帯の正孔との再結合に伴い、発光が生ずる。従って、カソードルミネッセンスのスペクトルからは、エネルギーバンド構造、結晶性、結晶中に含まれる欠陥や不純物について、情報を得ることができる。

【0054】本発明の焼結体について、カソードルミネッセンススペクトルを測定した結果、例えば図23、図25に例示するように、350~370nmの波長領域に強い主要ピークを有していることを発見した。また、650~750nmの波長領域に、この主要ピークの2倍波と思われる弱いピークを検出した。

【0055】また、本発明者は、比較対象として、窒化アルミニウム粉末に5重量%のイトリア粉末を添加して焼成することによって得られた高密度の焼結体を準備し、この焼結体についてカソードルミネッセンスを測定した。この結果、例えば図24、図25に示すように、

約 340 nm、500 nm、600 nm にそれぞれ弱いピークが観測された。

【0056】このような発光波長の相違は、発光種（バンドギャップ内の電子準位）の相違を示している。また、発光強度の相違は、不純物による電子濃度の相違を示している。つまり、本発明の焼結体の場合には、350～370 nm の波長領域に、非常に強い、シャープなピークが観測されたが、これは非常に強い新たな電子準位の存在を示しており、特定の不純物による電子濃度が高いことを示している。

【0057】次に、本発明者は、350～370 nm の波長領域に強い主要ピークをもたらし電子準位が、焼結体中の窒化アルミニウム結晶粒子中に存在しているのか、あるいはこの結晶粒子の粒界相に存在しているのかを特定するために、波長 360 nm の発光について、カソードルミネッセンス二次元マッピングを行った。

【0058】そして、このマッピングの結果を同じ試料の同じ視野の走査型電子顕微鏡写真と対比したところ、カソードルミネッセンスによる非常に強い波長 360 nm の発光は、窒化アルミニウム結晶粒子中に存在していることが判明した。一方、粒界部は暗く、前記の発光は見られなかった。これは、電子濃度が高い領域（局在電子準位が多い領域）が粒子内に分布しており、粒界部に分布していないことを示している。この結果から、結晶粒子それ自体の電気的特性が、焼結体の体積抵抗率に大きく影響していることが判明した。

【0059】また、本発明の焼結体について、X線マイクロアナライザー（EPMA）によって酸素濃度の分布を測定した。この結果、本発明の焼結体においては、粒子内に比較的多量の酸素原子が固溶していることが判明した。

【0060】本発明の焼結体においては、窒化アルミニウム結晶粒子内に、相対的に多量の酸素原子が固溶しており、これが局在電子準位を提供し、粒子内抵抗の低下に寄与しているものと考えられる。これは、ESR スペクトルにおける吸収ピークの強度が高いこととも整合している。

【0061】具体的に、本発明の焼結体を構成する窒化アルミニウム結晶粒子の酸素濃度を測定したところ、0.5 重量%以上である必要があることが判明した。これは、更に好ましくは 0.6 重量%以上である。また、この上限は特にないが、好ましくは、2.0 重量%以下であり、更に好ましくは 1.0 重量%以下である。

【0062】以上の実験結果を総合すると、次のプロセスによって結晶粒子の電気抵抗の低下が見られたものと推定される。即ち、窒化アルミニウム結晶粒子中に酸素が固溶する際に、酸素が窒素格子点（サイト）に入り、窒素と置換する。この際の窒素 $N^{\cdot-}$ と酸素 $O^{\cdot-}$ との間の電荷補償によって、伝導（ドナー）電子、又はアルミニウム空格子点が生成し、これらが電気伝導に大きく

寄与する。こうした伝導電子または空格子点の生成によって、窒化アルミニウム結晶粒子の内部における電気抵抗が低下し、焼結体の電気抵抗の低下に寄与したものと考えられる。

【0063】本発明者は、比較対象のイトットリアを 5 重量%添加した焼結体についても、X線マイクロアナライザー（EPMA）によって酸素濃度の分布を測定した。この結果、イトットリアを 5 重量%添加した焼結体の場合には、結晶粒子の内部の酸素濃度が、相対的に低くなっていた。しかも、この焼結体内において酸素が相対的に多く存在している部分は、イトットリアが存在している部分とほぼ重複していることがわかった。イトットリアは窒化アルミニウム粒子内に固溶せず、粒界部に排出されることが知られている。従って、酸素原子のほとんどは、粒子内には存在せず、粒界に存在している。

【0064】従って、焼結が進行する過程で粒子内からイトットリウムが排出され、この際にイトットリウムが酸素原子を粒界へと向かって持ち去る傾向がある。このために、粒子内の酸素原子が減少したものと考えられる。

【0065】次に、本発明の焼結体を得るための方法について説明する。窒化アルミニウム原料粉末としては、直接窒化法による粉末を使用でき、還元窒化法による粉末も使用できる。現状では、金属不純物含有量が少ないものが供給され易い点から、還元窒化法による粉末が好ましい。しかし、直接窒化法によって製造された粉末であっても、原料であるアルミニウムの純度を向上させ、かつ各工程における不純物の混入を防止すれば、問題なく使用できる。

【0066】最終的に得られる焼結体中において、窒化アルミニウム焼結体中の全酸素量と、希土類元素の酸化物中に含有されている酸素量との差を 0.5 重量%以上とすることが好ましいことから、むしろ、原料粉末中の酸素量が重要である。原料中の酸素量が少ない場合には、原料粉末中に酸素を導入するための後処理が必要になる。例えば、原料粉末を、空気等の酸化雰囲気中で、400～800℃で加熱することによって、酸化処理することで、原料粉末中の酸素量を増大させることができる。また、原料粉末中に各種アルミナ粉末およびアルミナ前駆体を添加することができる。

【0067】最終的に、脱脂および焼成工程に供する前の窒化アルミニウム原料粉末中の全酸素量から、希土類元素の酸化物中に含有されている酸素量を控除した値は、0.5 重量%以上とすることが好ましい。

【0068】しかし、焼結体を構成する各窒化アルミニウム結晶粒子中において、均一に酸素原子を分散させるためには、その原料粉末を製造した段階で、前記のような後処理を行うことなく、原料粉末中の酸素量を前記のように十分に大きくしておくことが好ましい。

【0069】また、希土類元素は、前記原料粉末に対して、種々の形態で添加することができる。例えば、窒化

アルミニウム原料粉末中に希土類元素の単体または化合物の粉末を添加することができる。

【0070】一般には、希土類元素の酸化物が最も入手し易い。ただし、希土類元素の酸化物を使用した場合には、本発明においては、希土類の添加量が微量であるために、希土類元素の酸化物の分散が不十分であると、焼結体の全体に希土類元素が行き渡ることが困難になる。このため、焼結体の各部分の体積抵抗率等の諸特性にバラツキが生ずる原因になる。

【0071】このため、本発明においては、希土類元素の硝酸塩、硫酸塩、アルコキシド等の化合物を、これらの化合物が可溶性である適当な溶剤に溶解させて溶液を得、この溶液を窒化アルミニウム原料粉末に対して添加することができる。これによって、希土類元素の添加量が微量であっても、希土類元素が焼結体の各部分に均一に分散される。しかも、おそらくは各粒子の表面に非常に薄い層として希土類元素が分散されることから、高抵抗である希土類元素化合物が偏析しにくくなる。分散が不十分である場合、局部的に希土類含有結晶が析出することがある。析出物の割合が少ない場合、本件の要件には影響しない。

【0072】乾式プレス成形法を使用する場合には、前記原料粉末を乾燥する方法としては、スプレードライ法を提案できる。これは、微量添加物である希土類化合物の瞬間乾燥法として特に好適である。

【0073】また、テープ成形法を使用することができる。この場合には、希土類元素の硝酸塩、硫酸塩、アルコキシド等の化合物を溶解させて得た溶液を、通常のテープ成形工程の中に添加剤として添加すれば良い。添加量も微量であるので、成形性、脱脂性には影響しない。

【0074】調合工程においては、溶剤中に窒化アルミニウム原料粉末を分散させ、この中に希土類元素化合物を、前記した酸化物粉末や溶液の形で添加することができる。混合を行う際には、単純な攪拌によっても可能であるが、前記原料粉末中の凝集物を解砕する必要がある場合には、ボットミル、トロンメル、アトリクションミル等の混合粉碎機を使用できる。添加物として、粉碎用の溶媒に対して可溶性のものを使用した場合には、混合粉碎工程を行う時間は、粉末の解砕に必要な最小限の短時間で良い。また、ポリビニルアルコール等のバインダー成分を添加することができる。

【0075】この粉碎用溶剤を乾燥する工程は、スプレードライ法が好ましい。また、真空乾燥法を実施した後、乾燥粉末をフルイに通してその粒度を調整することが好ましい。

【0076】粉末を成形する工程においては、円盤形状の成形体を製造する場合には、金型プレス法を使用できる。成形圧力は、 100 kgf/cm^2 以上とすることが好ましいが、保型が可能であれば、特に限定はされない。粉末の状態ではホットプレスダイス中に充填すること

も可能である。

【0077】成形体中にバインダーを添加した場合には、焼成に先立って、酸化雰囲気中で $200^\circ\text{C}\sim 800^\circ\text{C}$ の温度で脱脂を行うことができる。

【0078】希土類元素を含有する添加剤を、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩の形で添加した場合には、焼成に先立って、粉末状態の原料または粉末の成形体について、脱硝、脱硫、脱炭酸処理することができる。こうした脱ガス工程は、脱脂工程と同様に、酸化雰囲気中で前記原料粉末または成形体を加熱することによって実施できるが、この際、発生する NO_x ガス、 SO_x ガス等による窯の損傷に留意する必要がある。

【0079】また、脱硝、脱硫、脱炭酸処理等の脱ガス工程を個別に実施することなく、焼成過程の間に脱ガスをも行わせることができる。

【0080】次いで成形体をホットプレス法によって焼成する。ホットプレス時の圧力は、 50 kgf/cm^2 以上である必要があり、 200 kgf/cm^2 以上が好ましい。この上限は特に限定されないが、モールド等の窯道具の損傷を防止するためには、実用上は 1000 kgf/cm^2 以下が好ましく、 400 kgf/cm^2 以下が更に好ましい。

【0081】圧力を上昇させる際には、最高圧力まで一気に上昇させることも可能である。しかし、昇温に従って段階的に圧力を上昇させることが、焼結体の寸法精度を向上させるために、特に好ましい。

【0082】円盤形状の成形体をホットプレス法によって焼成する際には、この成形体の外径よりも若干大きい内径を有するスリーブの中に成形体を収容することが好ましい。

【0083】温度上昇時に脱ガスが必要な場合には、室温 $\sim 1600^\circ\text{C}$ の間の温度範囲において、真空加熱を行うことによって、気体の発散を促進することが好ましい。

【0084】また、焼成時の最高温度まで、 50°C /時間以上、 1500°C /時間以下の昇温速度で温度を上昇させることが好ましい。最高温度は、 $1750^\circ\text{C}\sim 2300^\circ\text{C}$ とすることが好ましい。最高温度が 2300°C を越えると、窒化アルミニウムの分解が始まる。最高温度が 1750°C 未満であると、粒子の効果的な成長が抑制され、平均粒径 $3\mu\text{m}$ に達しない。

【0085】また、成形体を焼結する時間に関しては、 1850°C 以上、 1900°C 未満の最高温度では、少なくとも3時間の焼結を行う必要があった。 $1900^\circ\text{C}\sim 2000^\circ\text{C}$ 未満の最高温度でも、最高温度で2時間以上の保持を行う必要があった。更に、この保持時間を3時間以上、更には5時間以上とすることによって、一層体積抵抗率の低下が観測された。 2000°C 以上の最高温度では、最高温度で1時間以上の保持を行うことによって、体積抵抗率の低下が観測された。これらの保持時間

は、焼結炉における現実的な生産性の観点からは、300時間以下とすることが好ましい。最高温度から1400℃まで、300℃/時間の冷却速度で冷却した。1400℃において、電源を切り、自然放冷させた。冷却速度が抵抗に及ぼす影響は不明である。

【0086】ホットプレス法において、成形体または原料粉末とカーボン治具との間に窒化ホウ素を離型剤として塗布する方法が、現在提案されている。しかし、本発明においては、ホウ素が焼結体中に混入するおそれがあるので、この離型剤を使用しない方がよい。

【0087】以下、更に具体的な実験結果について述べる。表1および表2に示す各窒化アルミニウム焼結体を製造した。表3および表4、表5および表6についても同様である。原料粉末としては、還元窒化法によって得られた窒化アルミニウム粉末を使用した。この原料粉末中の酸素量、金属不純物量を表1、3、5に示す。イットリウムの硝酸塩をイソプロピルアルコールに溶解させて添加剤溶液を製造し、この添加剤溶液を窒化アルミニウム原料粉末に対して、ポットミルを使用して混合した。Y、O、に換算したイットリアの混合比率、およびアルミナの添加量を、表1、3、5に示す。

【0088】この原料粉末を100kgf/cm²の圧力で一軸加圧成形することによって、直径200mmの円盤状成形体を作製した。この円盤状成形体をホットプレス型中に収容し、密封した。昇温速度300℃/時間で温度を上昇させ、この際、室温～1000℃の温度範囲で減圧を行った。この温度の上昇と同時に圧力を上昇させた。最高温度を、表2、4、6に示すように変更

し、表2、4、6に示す各キープ時間の間、各最高温度で保持した。

【0089】こうして得られた焼結体について、イットリウムを除く金属不純物量の合計値を測定し、表1、3、5に示す。また、イットリウムの含有量(Y)、全酸素量(O)全炭素量(C)および過剰酸素(全酸素量と、イットリアに含有される酸素量との差)を、表1、3、5に示す。また、各焼結体について、下記の各値を測定し、表2、4、6に示す。

10 【0090】(g値) ESRの共鳴条件式から、g値を求めた。この式は、 $h\nu = g/\mu B H$ (hはプランク定数であり、 ν はマイクロ波の振動数であり、 μB はボーア磁子であり、Hは磁場である)。

(スピン数 (spin/mg)) 前記のようにして算出した。

【0091】(平均粒径) 電子顕微鏡写真を撮影し、観察された粒子の長軸長さの平均値を算出して求めた。

(熱伝導率) レーザーフラッシュ法にて測定した。

(強度) JIS1601に基づいた室温四点曲げ強度試験法によって測定した。

(相対密度) アルキメデス法にて測定した。

(色彩) 外観を目視によって観察した。

(体積抵抗率) JISC2141に基づいた絶縁物の体積抵抗率測定法で測定した。各表および図面には、略記法を使用して表示した。例えば、「1E+06」は「1×10⁶」を示す。

【0092】

【表1】

No.		体積抵抗率 Ω・cm	原料中酸素量 wt%	原料中金属不純物量 (ppm)	Y2O3添加量 (wt%)	Al ₂ O ₃ 添加量 (wt%)	Yを除く金属不純物 (ppm)	Y (ppm)	O (wt%)	C (wt%)	過剰酸素 (wt%)
1	比較例	3E+14	1.8	5000	0.050	0	4500	350	1.70	0.05	1.69
2	比較例	4E+13	1.5	3500	0.050	0	3100	320	1.40	0.05	1.39
3	比較例	3E+12	1.2	3000	0.050	0	2800	350	1.10	0.05	1.09
4	比較例	7E+12	1.0	1100	0.050	0	980	300	0.80	0.05	0.79
5	実施例	7E+09	0.9	850	0.050	0	710	350	0.80	0.03	0.79
6	実施例	8E+07	1.0	450	0.050	0	430	280	0.88	0.04	0.87
7	実施例	8E+07	1.1	250	0.050	0	250	310	0.90	0.04	0.89
8	実施例	9E+07	1.1	160	0.050	0	150	270	1.00	0.03	0.99
9	実施例	6E+07	0.9	130	0.050	0	120	290	1.10	0.03	1.09
10	実施例	2E+07	1.2	120	0.050	0	100	340	0.80	0.02	0.79
11	実施例	1E+07	1.2	90	0.050	0	90	320	0.90	0.03	0.89
12	実施例	8E+06	0.8	70	0.050	0	80	360	0.80	0.04	0.59
13	実施例	8E+06	0.9	30	0.050	0	30	340	0.80	0.02	0.79
14	実施例	1E+07	1.2	90	0.050	0	90	320	0.90	0.03	0.89

【0093】

【表2】

No		最高 温度 (°C)	キープ 時間 (Hr)	g 値	スピンドル 量 $\times 10^3$ spin/mg	粒径 μm	熱伝導 率 W/mK	強度 (MPa)	相対密度 (%)	色彩
1	比較例	2000	5	2.0032	0.4	12	70	320	98.9	黒色
2	比較例	1950	5	2.0020	0.3	9	60	290	98.6	灰色
3	比較例	2000	5	2.0021	0.3	13	60	310	99.3	鉛色
4	比較例	2000	5	2.0008	1.0	13	70	290	99.5	鉛色
5	実施例	2000	5	1.9975	1.8	10	80	330	99.6	鉛色
6	実施例	2000	5	1.9972	1.9	11	80	340	99.6	鉛色
7	実施例	2000	5	1.9974	2.1	9	80	330	98.8	鉛色
8	実施例	2000	5	1.9972	2.8	8	90	290	99.9	鉛色
9	実施例	2000	5	1.9977	2.9	9	100	340	99.8	鉛色
10	実施例	2000	5	1.9976	2.8	12	70	390	99.7	鉛色
11	実施例	2000	5	1.9977	2.9	11	60	320	99.9	鉛色
12	実施例	2000	5	1.9965	3.5	10	80	310	99.9	鉛色
13	実施例	2000	5	1.9964	4.2	9	60	330	99.8	鉛色
14	実施例	2200	1	1.9998	2.9	12	70	310	99.9	鉛色

【0094】

20 【表3】

No		体積抵抗 $\Omega \cdot cm$	原料酸素 量 wt%	原料中不 純物量 (ppm)	Y2O3 添加量 (wt%)	Al ₂ O ₃ 添加量 (wt%)	Yを金 属物 不 (ppm)	Y (ppm)	O (wt%)	C (wt%)	過剰酸 素 (wt%)
15	比較例	2B+13	1.2	90	10	0	80	900	0.10	0.03	0.08
16	比較例	5B+12	1.2	90	8	0	80	870	0.10	0.02	0.08
17	比較例	4B+12	1.2	90	5	0	70	780	0.20	0.03	0.18
18	比較例	4B+14	1.2	90	5	0	80	32500	1.98	0.02	1.11
19	比較例	5B+12	1.2	90	3	0	80	790	0.20	0.02	0.18
20	比較例	9B+12	1.2	90	2	0	80	540	0.30	0.03	0.29
21	比較例	5B+14	1.2	90	1	0	90	6000	1.30	0.04	1.14
22	比較例	4B+12	1.2	90	1	0	70	660	0.20	0.02	0.18
23	実施例	1B+12	1.2	90	0.8	0	90	670	0.50	0.03	0.48
24	実施例	2B+08	1.2	90	0.8	0	80	560	0.85	0.01	0.83
25	実施例	9B+08	1.2	90	0.5	0	80	450	0.90	0.03	0.89
26	実施例	1B+08	1.2	90	0.2	0	80	560	0.85	0.02	0.83
27	実施例	5B+07	1.2	90	0.1	0	80	640	0.92	0.03	0.90
28	実施例	2B+07	1.2	90	0.07	0	90	450	0.95	0.03	0.94
29	実施例	1B+07	1.2	90	0.05	0	70	320	0.84	0.02	0.83

【0095】

【表4】

No		最高温度 (℃)	キープ 時間 (Hr)	g 値	スピン量 $\times 10^{14}$ spin/mg	粒径 μm	熱伝率 W/mK	強度 (MPa)	相対密度 (%)	色彩
15	比較例	2000	5	2.0022	0.4	12	130	290	99.9	灰色
16	比較例	2000	5	2.0009	1.0	10	140	280	99.8	鉛色
17	比較例	2000	5	1.9971	0.8	11	190	310	99.6	鉛色
18	比較例	1850	2	2.0032	0.3	3	150	320	99.9	灰色
19	比較例	2000	5	1.9982	0.5	12	130	330	99.9	鉛色
20	比較例	2000	5	1.9983	0.7	9	110	380	99.8	鉛色
21	比較例	1850	2	2.0022	0.3	2	120	380	99.7	灰色
22	比較例	2000	5	1.9971	0.8	8	100	270	99.7	鉛色
23	比較例	2000	5	1.9981	1.1	10	90	310	99.8	鉛色
24	実施例	2000	5	1.9982	2.0	12	90	300	99.6	鉛色
25	実施例	2000	5	1.9985	1.9	10	120	350	99.9	鉛色
26	実施例	2000	5	1.9970	2.2	8	90	320	99.8	鉛色
27	実施例	2000	5	1.9988	2.9	9	80	300	99.7	鉛色
28	実施例	2000	5	1.9962	4.3	11	110	290	99.9	鉛色
29	実施例	2000	5	1.9963	3.5	11	90	350	99.8	鉛色

【0096】

【表5】

No.		体積率 $\Omega \cdot cm$	原料酸量 wt%	原料中 金属純物量 (ppm)	Y ₂ O ₃ 添加量 (wt%)	Al ₂ O ₃ 添加量 (wt%)	Yを 金属純物 不 (ppm)	Y (ppm)	O (wt%)	C (wt%)	過剰 酸素 (wt%)
36	実施例	6E+08	1.2	90	0.10	2	80	500	1.73	0.02	1.72
37	実施例	9E+08	1.2	90	0.10	2	80	450	1.73	0.02	1.72
38	実施例	9E+08	1.2	90	0.10	1	80	600	1.30	0.02	1.28
39	実施例	7E+08	1.2	90	0.10	0.5	80	600	1.00	0.03	0.98
40	実施例	4E+07	1.2	90	0.10	0	90	460	0.77	0.02	0.76
41	実施例	6E+08	1.2	90	0.10	0	90	450	0.75	0.02	0.74
42	実施例	7E+08	1.2	90	0.10	0	90	520	0.86	0.03	0.84
43	実施例	8E+08	1.2	90	0.10	0	80	400	0.80	0.01	0.79
44	実施例	5E+09	1.2	90	0.10	0	90	350	0.80	0.05	0.79
46	比較例	4E+14	1.2	90	0.10	0	90	70	0.95	0.01	0.95

【0097】

【表6】

No.		最高温度 (°C)	キープ 時間 (Hr)	g 値	スピン量 $\times 10^{17}$ spin/mg	粒径 μm	熱伝導率 W/mK	強度 (MPa)	相対密度 (%)	色彩
36	実施例	2000	5	1.9970	1.9	11	80	280	99.6	鉛色
37	実施例	1900	5	1.9971	1.9	10	70	320	99.7	鉛色
38	実施例	2000	5	1.9969	2.2	9	80	310	99.8	鉛色
39	実施例	2000	5	1.9975	2.2	8	90	250	99.8	鉛色
40	実施例	1950	5	1.9972	2.7	9	90	330	99.8	鉛色
41	実施例	1900	5	1.9972	2.7	8	90	330	99.8	鉛色
42	実施例	1850	5	1.9975	2.4	7	100	310	99.9	鉛色
43	実施例	1800	5	1.9978	2.1	5	100	350	99.9	鉛色
44	実施例	1780	5	1.9971	1.9	3	90	290	99.5	鉛色
46	比較例	1700	5	2.0023	0.5	2	80	260	98.5	灰色

【0098】表1、2においては、焼結体中において、イットリウムを除く金属不純物量を種々変更している。また、イットリウムを除く金属不純物量と体積抵抗率との関係を図2に示す。この結果、金属不純物量が500ppm以下であると、体積抵抗率が著しく減少している。

【0099】表3、4においては、 Y_2O_3 の添加量を種々変更しており、図3には、 Y_2O_3 の添加量と焼結体の体積抵抗率との関係を示す。 Y_2O_3 の添加量を0.5重量%以下とすることによって体積抵抗率が顕著に減少し、0.1重量%以下とすることによって、一層顕著に減少している。これ以下の領域では、体積抵抗率に特に顕著な相違は見られない。

【0100】図4は、過剰酸素と体積抵抗率との関係を示すグラフである。このグラフから判るように、過剰酸素、即ち窒化アルミニウム結晶粒子中に存在する酸素量が0.5重量%未満になると、体積抵抗率が著しく上昇している。過剰酸素が0.5~2.0重量%の範囲内においては、体積抵抗率が大きい($1 \times 10^{11} \Omega \cdot cm$ 以上)焼結体と、体積抵抗率が $1 \times 10^{11} \Omega \cdot cm$ 以下の試料とが併存している。これは、窒化アルミニウム粒子内に酸素が固溶しても、粒径が小さい場合、抵抗が低下しないためと考えられる。

【0101】図5は、ESRスペクトルから得られたg値と体積抵抗率との関係を示すグラフである。この結果から判るように、g値が2.000を越えると、体積抵抗率が著しく上昇している。一方、g値が2.000以下である場合はやはり体積抵抗率が大きい($1 \times 10^{11} \Omega \cdot cm$ 以上)焼結体と、体積抵抗率が $1 \times 10^{11} \Omega \cdot cm$ 以下の試料とが併存している。

【0102】図6は、ESRスペクトルによる、アルミニウムの単位mg当たりのスピン数と体積抵抗率との関係を示すグラフである。この結果から判るように、このスピン数を $1 \times 10^{17} spin/mg$ 以上とすることによって、体積抵抗率が著しく減少した。

【0103】また、表3、表4においては、原料中酸素

量および金属不純物量を最適化しており、イットリウムの含有量を変更しているが、この結果から判るように、体積抵抗率を一層減少させるためには、焼結体中のイットリウムの含有量は1000ppm以下とすることが好ましく、300ppm以上とすることが好ましい。

20 【0104】表5、表6においては、原料中酸素量および金属不純物量を最適化しており、焼成時の最高温度を変更しているが、最高温度が低いと、粒成長が十分ではなく、このために体積抵抗率が $1 \times 10^{11} \Omega \cdot cm$ の水準には到達しない。

【0105】図7は、番号11の焼結体についての結晶構造を示す走査型電子顕微鏡写真である。図8は、この焼結体の三重点の近傍を拡大して示す透過型電子顕微鏡写真であり、図9は、隣接する結晶粒子の界面を拡大して示す透過型電子顕微鏡写真である。隣接する各結晶粒子の界面には粒界相は見られないが、三重点にはアルミニウム酸化物相が生成している。

【0106】図10は、本発明例の番号11の焼結体について、結晶粒子の粒界のEDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometer) による分析の結果を示すグラフであり、微量のイットリウムが存在していることが判る。ただし、「C」のピークは、試料の汚染によるものである。図11は、同じ試料の結晶粒子中のEDSによる分析の結果を示すグラフである。イットリウムのピークはまったく見られず、酸素のピークが存在していることが判る。

【0107】図12、図13は、比較例の番号16の焼結体について、結晶粒子の内部のEDSによる分析の結果を示すグラフである。酸素のピークもイットリウムのピークも見られない。図14は、これと同じ焼結体について、結晶粒子の間にある粒界のEDSによる分析の結果を示すグラフである。顕著なイットリウムのピークが観測された。このイットリウムを多量に含有する粒界相が、隣接する結晶粒子の間の抵抗値の上昇に寄与している。

【0108】図15は、比較例の番号16の焼結体につ

いて、三重点のEDSによる分析の結果を示すグラフである。一層顕著なイットリウムピークが観測された。

【0109】図16は、本発明例の番号11の焼結体についてのX線回折ピークを示すグラフである。このグラフから判るように、イットリウム化合物の結晶に該当するピークは存在しておらず、従って結晶粒子の界面においてイットリウムは結晶相を構成していない。

【0110】図17は、本発明例の番号11の焼結体についての、隣接する結晶粒子の粒界付近の結晶組織を示す高倍率TEM写真である。この写真中の左右にそれぞれ結晶粒子が存在しており、左右方向にある各結晶粒子の間に界面がある。各結晶粒子内においては、結晶格子の構成原子が、完全に秩序的な結晶格子を形成している。結晶粒子の粒界付近においては、僅かに結晶格子が乱れているが、結晶格子が乱れた部分の幅は極めて小さく、原子数で数個程度であり、1nm以下に過ぎないことが判明した。

【0111】図18は、比較例の番号16の焼結体についての、隣接する結晶粒子の粒界付近の結晶組織を示す高倍率TEM写真である。左右の粒子の粒界付近で結晶格子の乱れが認められる。この幅は1~3nm程度である。制限視野電子線回折結果から、粒界には結晶質の析出物が検出された。この結晶格子の乱れは、粒界に析出した微小な析出によるものと考えられる。

【0112】図19、図20は、比較例の番号16の焼結体についての透過型電子顕微鏡写真である。3重点、粒界に、黒色の析出物(0.2μm)が観察された。この析出物をEDSで観察した結果、Y, Al, O, が検出された。また、この析出物は結晶質であった。

【0113】こうした本発明例の焼結体の微構造の特徴について、図21の模式図を参照しつつ、更に説明する。本発明例の焼結体においては、隣接する各結晶粒子1Aと1Bとの粒界2、1Bと1Cとの粒界2、1Cと1Aとの粒界2について、通常結晶粒子の間に存在すべき粒界相が存在しておらず、隣接する各結晶粒子の粒界2における結晶格子の乱れがほとんどない。そして、この結晶格子の乱れの部分に、イットリウム原子が混入しているものと推定される。この推定は、イットリウム化合物の結晶相がX線回折法によってまったく検出されない事実とも整合している。

【0114】各結晶粒子1A、1B、1C中には、それぞれ前記したように酸素が固溶している。また、三重点3においても、イットリウムは検出されないことが判つ

た。ただし、三重点3においても、イットリウムは結晶粒子の表面には存在している。

【0115】また、比較例の焼結体においては、図22(a)に示すように、隣接する結晶粒子5Aと5Bとの界面6は、不規則に入り乱れた形状をしており、複雑に折れ曲がっていた。この粒界相の幅は1~3nm程度であった。これに対して、本発明例の焼結体においては、図22(b)に示すように、結晶粒子1Aと1Bとの界面2は、ほぼ真直ぐに延びており、その幅は1nm以下であった。また、この界面の位置ずれは、アルミニウム原子数個のレベルであった。

【0116】次に、表7、表8の実験番号51~63の各窒化アルミニウム焼結体を製造した。原料粉末としては、還元窒化法によって得られた窒化アルミニウム粉末を使用した。この原料粉末中の酸素量、金属不純物量を、表7に示す。イットリウムの硝酸塩をイソプロピルアルコールに溶解させて添加剤溶液を製造し、この添加剤溶液を窒化アルミニウム原料粉末に対して、ポットミルを使用して混合した。Y, O, に換算したイットリアの添加量を、表7に示す。

【0117】この原料粉末を100kgf/cm²の圧力で一軸加圧成形することによって、直径200mmの円盤状成形体を作製した。この円盤状成形体をホットプレス型中に收容し、密封した。昇温速度300℃/時間で温度を上昇させ、この際、室温~1000℃の温度範囲で減圧を行った。この温度の上昇と同時に圧力を上昇させた。最高温度を、表8に示すように変更し、表8に示す各キープ時間の間、各最高温度で保持した。

【0118】こうして得られた各焼結体について、イットリウムを除く金属不純物量の合計値を測定し、表7に示す。また、焼結体中のイットリウムの含有量(Y)、全酸素量(O)、全炭素量(C)、過剰酸素(全酸素量と、イットリアに含有される酸素量との差)を、表7に示す。また、各焼結体について、g値、スピン数、平均粒径、熱伝導率、強度、相対密度、色彩を、前述したようにして測定し、その結果を表8に示す。

【0119】更に、各焼結体について体積抵抗率を前述のように測定した。また、X線マイクロアナライザーによって、各焼結体を構成する各窒化アルミニウム結晶粒子中の酸素濃度を測定した。これらの測定結果を表7に示す。

【0120】

【表7】

10

20

30

40

No.		体積抵抗率 $\Omega \cdot \text{cm}$	原料中 酸素量 wt%	原料中 金属純物 (ppm)	Y2O3 添加量 (wt%)	Yを 金属純物 不純物 (ppm)	Y (ppm)	O wt%	C wt%	過剰 酸素 wt%	EPMA 粒内酸素 wt%
51	比較例	4.2E+14	1.2	90	5	90	36900	1.98	0.03	0.98	0.35
52	比較例	8.2E+12	1.2	90	5	90	1100	0.25	0.02	0.22	0.21
53	実施例	4.8E+11	1.2	90	0.03	80	210	0.69	0.03	0.68	0.65
54	実施例	6.8E+7	1.2	90	0.05	70	350	0.8	0.03	0.79	0.78
55	実施例	5.0E+11	1.2	90	0.1	90	770	0.68	0.03	0.66	0.52
56	実施例	1.7E+11	1.2	90	0.1	80	630	0.64	0.03	0.62	0.57
57	実施例	2.8E+10	1.2	90	0.1	80	610	0.65	0.03	0.63	0.61
58	実施例	3.3E+9	1.2	90	0.1	70	510	0.62	0.03	0.61	0.61
59	実施例	4.1E+9	1.2	90	0.1	70	450	0.63	0.03	0.62	0.61
60	実施例	8.0E+10	1.2	90	0.3	80	1900	0.68	0.03	0.63	0.61
61	実施例	3.0E+10	1.2	90	0.3	80	650	0.59	0.03	0.57	0.55
62	実施例	7.0E+10	1.2	90	0.5	70	2000	1.31	0.03	1.26	0.59
63	実施例	3.0E+9	1.2	90	0.5	80	880	1.19	0.03	1.17	0.61

【0121】

20 【表8】

No.		最高 温度 ($^{\circ}\text{C}$)	キ ー フ 時 間 Hr	g 値	スピ ン 量 $\times 10^4$ spin/mg	粒 径 μm	熱 伝 率 W/mK	強 度 MPa	相 対 密 度 (%)	色 彩
51	比較例	1750	5	2.001	0.1	1	150	260	98.8	黒色
52	比較例	1850	5	2.0008	0.6	10	190	300	98.5	灰色
53	実施例	1850	5	1.9976	1.9	4	80	350	99.3	灰色
54	実施例	2000	5	1.9976	2.4	11	90	320	99.9	灰色
55	実施例	1800	5	1.9977	1.8	4	80	400	99.6	灰色
56	実施例	1850	5	1.9976	1.9	6	90	350	99.7	灰色
57	実施例	1900	5	1.9977	2	7	90	340	99.7	灰色
58	実施例	2000	5	1.9977	2.2	11	90	300	99.9	灰色
59	実施例	1900	10	1.9975	2.3	11	90	310	99.8	灰色
60	実施例	1900	5	1.9975	2.3	7	90	310	99.7	灰色
61	実施例	2000	5	1.9977	2.4	9	100	290	99.8	灰色
62	実施例	1900	5	1.9976	2.3	8	100	320	99.8	灰色
63	実施例	2000	5	1.9976	2.5	10	100	300	99.9	灰色

【0122】比較例51、52の各焼結体においては、原料中へのイットリアの添加量が5重量%であり、焼結体中にも約3.7重量%または0.1重量%残留している。X線マイクロアナライザーによって結晶粒子内の酸素量を測定したところ、0.35重量%または0.21重量%であった。つまり実験番号52の方が相対的にホットプレス温度が高いために、焼結過程におけるイットリアの排出が進行し、結晶粒子内の酸素の排出も進行している。

【0123】そして焼結体の体積抵抗率は、比較例51においては $10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 台であり、比較例52にお

いては $10^1 \Omega \cdot \text{cm}$ 台であって、比較例52の方が体積抵抗率が低くなっているが、これは比較例52の方が、イットリアの排出と共に、粒成長が進行しているためと考えられる。

【0124】これに対して、実施例53～63においては、X線マイクロアナライザーによって測定した結晶粒子内の酸素量が0.5重量%以上であって、「過剰酸素」の量も0.5重量%以上になっている。そして、実施例62、63を除いて、「過剰酸素」の大部分が結晶粒子内に分布していることがわかる。

【0125】また、実施例53～63においては、焼結

体中におけるイットリアの量が0.2重量%以下であり、g値が2.000以下であり、スピニング数が 1.0×10^4 spin/mg以上であり、平均粒径が $4 \mu\text{m}$ 以上であり、相対密度が99%以上である。これらの焼結体においては、 $10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下の体積抵抗率が得られている。

【0126】次に、本発明者は、前記した表1～表8に示す各実験番号の焼結体について、カソードルミネッセンスによるスペクトルを測定した。この結果、前述したように、350～370nmに強い主要ピークが現れた。焼結体において、体積抵抗率の著しい低下が見られることを見いだした。

【0127】こうした波長350～370nmの範囲内のピークは、実施例5～14、実施例23～29、実施例36～44、実施例53～63において確認された。以下、煩雑さを避けるために、代表として、特に実施例54の焼結体と、比較例52の焼結体とについて、具体的にスペクトル等の測定プロセスと詳細なデータを提示する。

【0128】実施例54の焼結体の表面をダイヤモンドペーストによって鏡面研磨し、カソードルミネッセンス法でスペクトルを観測し、その結果を図23に示した。図23において、縦軸は発光強度であり、横軸はルミネッセンスの波長である。350～370nmの波長領域に強いピークがあり、650～750nmの波長領域に弱いピークがある。

【0129】一方、比較例52の焼結体の表面をダイヤモンドペーストによって鏡面研磨し、カソードルミネッセンス法でスペクトルを観測し、その結果を図24に示した。この結果、約340nm、500nm、600nmにそれぞれ弱いピークが観測された。

【0130】図25には、実施例54と比較例52との各カソードルミネッセンスによるスペクトルを対比して示す。このように、本発明の焼結体に特徴的に見られた350～370nmの主要ピークの発光強度は、比較例の焼結体の各ピークに比べて極めて高い。

【0131】また、実施例54の焼結体について、360nmの波長でのカソードルミネッセンス二次元マッピングを行った結果を、図26に示す。ただし、図27は、図26の二次元マッピングにおける濃淡と発光強度との関係を示す。また、図28は、図26と同じ視野における、セラミックス組織の走査型電子顕微鏡写真である。

【0132】図26の二次元マッピングの結果においては、濃淡のコントラストが見られる。この二次元マッピングを図28の写真と対比すると、図28の写真に見える各粒子の形状と、図26における濃い部分の形状、あるいは淡い部分の形状が、完全に重なることがわかった。

【0133】従って、二次元マッピングにおける濃淡

は、各結晶粒子の結晶方位に依存しているものと考えられる。つまり、ある結晶粒子が、電子線に対して垂直な結晶方位を有している場合にはカソードルミネッセンスの発光強度が増大している。このように、図28に見える各結晶粒子ごとの結晶方位の相違が、そのまま図26における濃淡の原因になっている。そして、図26において、粒界にあたる部分は常に暗く、発光が見られない。以上の測定結果から、非常に強い波長360nmの発光は、結晶粒子中に存在していることが判明した。

10 【0134】また、比較例52の焼結体について、X線マイクロアナライザー (EPMA) によって酸素濃度分布とイットリウム原子の分布とを測定した。この結果、比較例52の焼結体の場合には、酸素濃度が相対的に低くなっていた。しかも、焼結体内において酸素が相対的に多く存在している部分は、イットリアが存在している部分とほぼ重複していた。この重複部分は、走査型電子顕微鏡写真に示された粒界部の位置とほぼ一致していた。

20 【0135】本発明の窒化アルミニウム焼結体中に金属を埋設することができ、特に不純物を嫌悪する環境下で使用される電極埋設品として特に好適に使用できる。こうした用途としては、例えば、セラミック静電チャック、セラミックスヒーター、高周波電極装置を例示することができるが、特に静電チャックに対して、きわめて好適に使用することができる。

30 【0136】本発明の金属包含材を、例えば半導体ウエハーの吸着用の静電チャックとして使用すると、特に誘電層における室温での体積抵抗率を $1.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下とできることから、室温付近または -60°C 以下の温度範囲において、静電チャックとしての吸着特性を著しく向上させることができる。この場合には、誘電層の厚さを $500 \mu\text{m}$ 以上としても、電圧を印加したときに、電極から電荷が移動して絶縁性誘電層の表面に現れ、十分な吸着力を得ることが出来る。また、電圧遮断直後に、電荷は十分な速さで消散するので、ウエハーを脱着する際の応答性も良い。これによって、特に -60°C 程度の低温領域から、 300°C 以上の高温領域までの極めて広い温度範囲において、8インチ以上の大型の半導体ウエハーを、十分に安定して吸着し、保持することができるようになった。

40 【0137】このように窒化アルミニウム焼結体中に埋設される金属部材は、面状の金属バルク材であることが好ましい。この際、金属埋設品が静電チャックである場合には、金属部材は、金属バルク材からなる面状の電極である。ここで、「面状の金属バルク材」とは、例えば、線体あるいは板体をらせん状、蛇行状に配置することなく、例えば、図30に示すように、金属を一体の面状として形成したものをいう。

50 【0138】金属部材は、窒化アルミニウム粉末と同時に焼成するので、高融点金属で形成することが好まし

い。こうした高融点金属としては、タンタル、タングステン、モリブデン、白金、レニウム、ハフニウム及びこれらの合金を例示できる。半導体汚染防止の観点から、更に、タンタル、タングステン、モリブデン、白金及びこれらの合金が好ましい。静電チャックによる被処理物としては、半導体ウエハーの他、アルミニウムウエハー等を例示できる。

【0139】こうした面状のバルク材としては、次を例示できる。

(1) 薄板からなる、面状のバルク材。

(2) 面状の電極の中に多数の小空間が形成されているバルク材。これには、多数の小孔を有する板状体からなるバルク材や、網状のバルク材を含む。多数の小孔を有する板状体としては、パンチングメタルを例示できる。ただし、バルク材が高融点金属からなり、かつパンチングメタルである場合には、高融点金属の硬度が高いため、高融点金属からなる板に多数の小孔をパンチによって開けることは困難であり、加工コストも非常に高くなる。この点、バルク材が金網である場合には、高融点金属からなる線材が容易に入手でき、この線材を編組すれば金網を製造できる。

【0140】こうした金網のメッシュ形状、線径等は特に限定しない。しかし、線径 $\phi 0.03\text{mm}$ 、 150メッシュ ～線径 $\phi 0.5\text{mm}$ 、 6メッシュ において、特に問題なく使用できた。また、金網を構成する線材の幅方向断面形状は、円形、楕円形、長方形等、種々の圧延形状であってよい。ここで、 1メッシュ は 1インチ あたり 1本 という意味である。

【0141】本発明を静電チャックに適用した場合には、静電チャック電極に対して高周波電源を接続し、この電極に対して直流電圧と同時に高周波電圧を供給することによって、この電極をプラズマ発生用電極としても使用することができる。この場合には、例えば電極がタングステンであり、周波数が 13.56MHz の場合、電極の厚さは $430\mu\text{m}$ 以上が望ましいが、この厚さの電極を、スクリーン印刷法で形成することは困難であるので、電極を金属バルク体によって構成する。また、誘電層の厚さが 0.5mm ～ 5.0mm の範囲内では、誘電体損失による自己発熱はさほど大きくないので、高周波電極として問題なく使用できる。

【0142】図29は、静電チャックの一例を概略的に示す断面図である。図30(a)は、図29の静電チャックのうち一部を切り欠いて示す斜視図であり、図30(b)は、金網からなる電極13を示す斜視図である。

【0143】略円盤形状の基体11の側周面11dにリング状のフランジ11cが設けられており、基体11の内部に、金網13からなる電極19が埋設されている。半導体ウエハー16の設置面11a側には、所定厚さの誘電層14が形成されている。基体のうち支持部分18側には、端子20が埋設されている。端子20の端面

が、基体11の裏面11bに露出している。基体11の所定箇所に、半導体ウエハー16を昇降させるためのピンを通す孔12が形成されている。

【0144】端子20に電線15Aを介して直流電源17が接続されている。また、半導体ウエハー16には、直流電源17の負極が、電線15Bを介して接続されている。本実施例における電極19は、図30(a)、

(b)に示すような金網13によって形成されている。金網13は、円形の枠線13aと、枠線13aの内部に縦横に形成されている線13bとからなっており、これらの間に網目24が形成されている。

【0145】電極19と背面11bとの間には、基体11内に抵抗発熱体21が埋設されている。この抵抗発熱体21の両端部は、それぞれ端子22に接続されており、端子22はそれぞれ外部端子23に接続されている。この抵抗発熱体は、半導体ウエハーを吸着しながら加熱するためのものであり、必ずしも必要ない。

【0146】また、本発明の窒化アルミニウム焼結体は、半導体ウエハーを設置するためのサセプター、ダミーウエハー、シャドーリング、高周波プラズマを発生させるためのチューブ、高周波プラズマを発生させるためのドーム、高周波透過窓、赤外線透過窓、半導体ウエハーを支持するためのリフトピン、シャワー板等の各半導体製造用装置の基体として、使用することができる。

【0147】また、本発明の窒化アルミニウム焼結体を適用できる電子機能材料としては、誘導加熱用加熱源（ヒーター材料）を例示できる。即ち、本発明の焼結体は、高純度であり、プラズマに対する耐蝕性が高いことから、プラズマ雰囲気中で使用するための誘導加熱用加熱源として利用できる。

【0148】本発明者は、図29に示す静電チャックを製造した。原料粉末としては、還元窒化法によって得られた窒化アルミニウム粉末を使用した。この原料粉末中の酸素量を $1.2\text{重量}\%$ とし、金属不純物量を 90ppm とした。イットリウムの硝酸塩をイソプロピルアルコールに溶解させて添加剤溶液を製造し、この添加剤溶液を窒化アルミニウム原料粉末に対して、ボットミルを使用して混合した。 Y_2O_3 に換算したイットリアの混合比率は $0.05\text{重量}\%$ であった。

【0149】電極19としては、モリブデン製の金網13を使用した。金網13は、直径 $\phi 0.5\text{mm}$ のモリブデン線を、 1インチ あたり 15本 の密度で編んだ金網を使用した。前記原料粉末の中に金網13を埋設し、金網13に対して垂直方向に向かって $100\text{kgf}/\text{cm}^2$ の圧力を加え、一軸加圧成形することによって、直径 200mm の内盤状成形体を作製した。この円盤状成形体をホットプレス型中に収容し、密封した。昇温速度 $300^\circ\text{C}/\text{時間}$ で温度を上昇させ、この際、室温～ 1000°C の温度範囲で減圧を行った。この温度の上昇と同時に圧力を上昇させた。最高温度を 2000°C とし、最高温

度で5時間保持した。

【0150】こうして得られた焼結体について前記の測定を行った。イットリウムを除く金属不純物量の合計値は90ppmであり、イットリウムの含有量(Y)は320ppmであり、全酸素量(O)は0.90重量%であり、全炭素量(C)は0.03重量%であり、過剰酸素は0.89重量%であった。また、この焼結体のESRスペクトルのg値は1.9977であり、ピーク比(A1/Mn)は3.50であり、スピン数は 2.9×10^{17} spin/mgであり、平均粒径は11μmであり、熱伝導率は60であり、強度は320MPaであり、相対密度は99.9%であった。

【0151】また、カソードルミネッセンスによるスペクトルを測定したところ、350~370nmの波長に、図23に示したものと同様の主要ピークが観察された。また、X線マイクロアナライザーによって、結晶粒子内の酸素濃度を測定したところ、0.79重量%であった。

【0152】得られた焼結体の誘電層側の表面を機械加工し、誘電層14の厚さを1mmとした。焼結体の背面11b側からマシニングセンターによって孔12を形成し、また端子20を電極19に接合した。ただし、抵抗発熱体21は埋設しなかった。静電チャックの寸法は、直径は200mmであり、厚さは12mmであった。この静電チャックの吸着力を測定した。室温から300℃まで100℃間隔で吸着力を測定したところ、いずれの温度においても、60~100g/cm²の吸着力を示した。また、誘電層の室温における体積抵抗率は、 $1 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ であった。

【0153】

【発明の効果】以上述べてきたように、本発明によれば、高純度であって、かつ低い体積抵抗率を有する、新規な窒化アルミニウム焼結体が提供することができる。また、こうした窒化アルミニウム焼結体からなる、半導体レベルの体積抵抗率を有する新規な電子機能材料を提供し、かつこの窒化アルミニウム焼結体を使用した静電チャックを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】カソードルミネッセンスの原理を説明するための模式図である。

【図2】イットリウムを除く金属不純物量と体積抵抗率との関係を示すグラフである。

【図3】Y、O、の添加量と焼結体の体積抵抗率との関係を示すグラフである。

【図4】過剰酸素と体積抵抗率との関係を示すグラフである。

【図5】ESRスペクトルから得られたg値と体積抵抗率との関係を示すグラフである。

【図6】ESRスペクトルによるスピン数と体積抵抗率との関係を示すグラフである。

【図7】本発明例の焼結体についてのセラミックス組織を示す走査型電子顕微鏡写真である。

【図8】図7の焼結体の三重点の周辺を拡大して示す、セラミックス組織の透過型電子顕微鏡写真である。

【図9】本発明例の焼結体について、隣接する結晶粒子の粒界を拡大して示す、セラミックス組織の透過型電子顕微鏡写真である。

【図10】本発明例の焼結体についての、隣接する結晶粒子の粒界のEDSによる分析の結果を示すグラフである。

【図11】図10の焼結体の、結晶粒子中のEDSによる分析の結果を示すグラフである。

【図12】比較例の焼結体についての、結晶粒子の内部のEDSによる分析の結果を示すグラフである。

【図13】比較例の焼結体についての、結晶粒子の内部のEDSによる分析の結果を示すグラフである。

【図14】図12の焼結体について、隣接する結晶粒子の粒界のEDSによる分析の結果を示すグラフである。

【図15】比較例の焼結体についての、三重点のEDSによる分析の結果を示すグラフである。

【図16】本発明例の焼結体についてのX線回折ピークを示すグラフである。

【図17】本発明例の焼結体についての、隣接する結晶粒子の粒界付近の結晶組織を示す、セラミックス組織の高倍率TEM写真である。

【図18】比較例の焼結体についての、隣接する結晶粒子の粒界付近の結晶組織を示す、セラミックス組織の高倍率TEM写真である。

【図19】比較例の焼結体のセラミックス組織の透過型電子顕微鏡写真である。

【図20】比較例の焼結体のセラミックス組織の透過型電子顕微鏡写真である。

【図21】本発明例の焼結体の微構造の特徴を示す模式図である。

【図22】(a)は、比較例の焼結体について、隣接する結晶粒子の界面の状態を説明するための模式図であり、(b)は、本発明例の焼結体について、隣接する結晶粒子の界面の状態を説明するための模式図である。

【図23】本発明例(実施例54)の焼結体のカソードルミネッセンスによるスペクトルを示す。

【図24】比較例52の焼結体のカソードルミネッセンスによるスペクトルを示す。

【図25】実施例54の焼結体と比較例52の焼結体とのカソードルミネッセンスによる各スペクトルを示す。

【図26】実施例54の焼結体のカソードルミネッセンス二次元マッピングを示す写真図である。

【図27】図26のカソードルミネッセンス二次元マッピングにおける濃淡と発光強度との関係を示す写真図である。

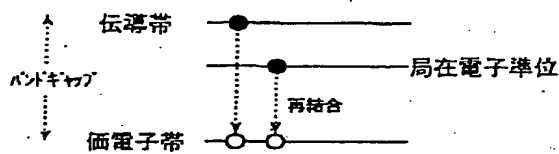
【図28】実施例54の焼結体について、図26と同じ

視野におけるセラミックス組織の走査型電子顕微鏡写真である。

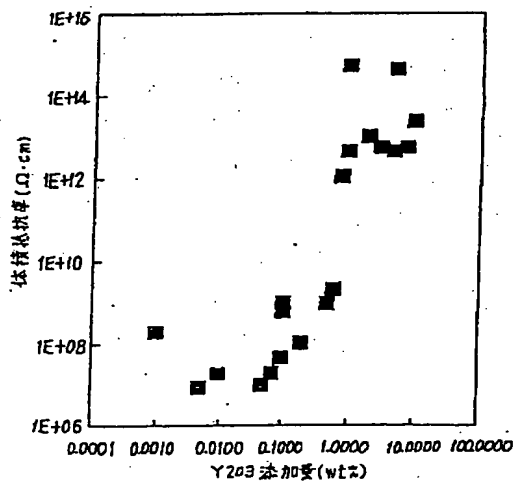
【図29】静電チャックの一例を概略的に示す断面図である。

【図30】(a)は、図23の静電チャックを切り欠いて示す要部断面斜視図であり、(b)は、静電チャック電極として使用できる金網の一例を示す斜視図である。

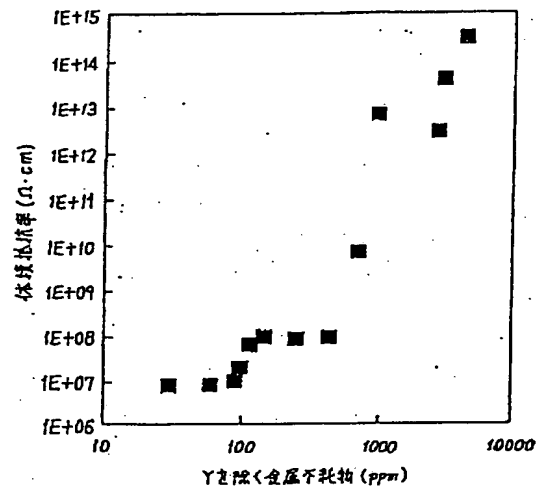
【図1】



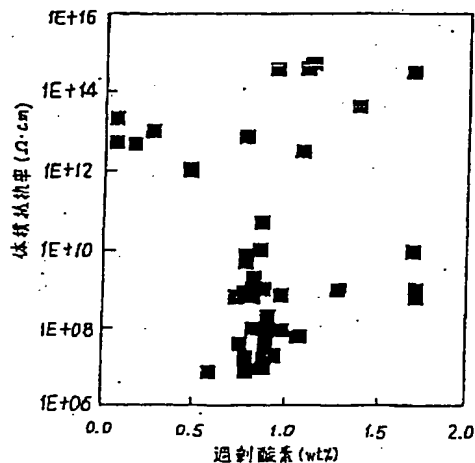
【図3】



【図2】



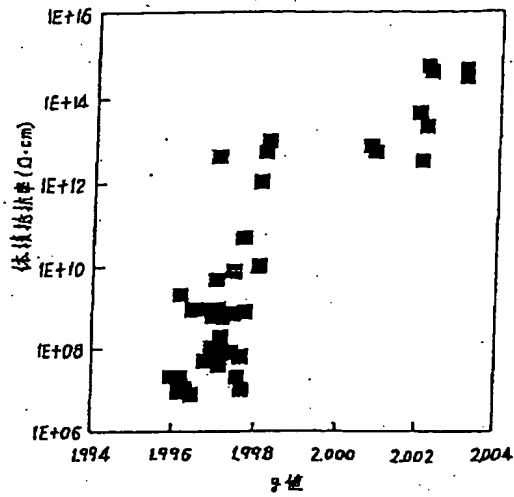
【図4】



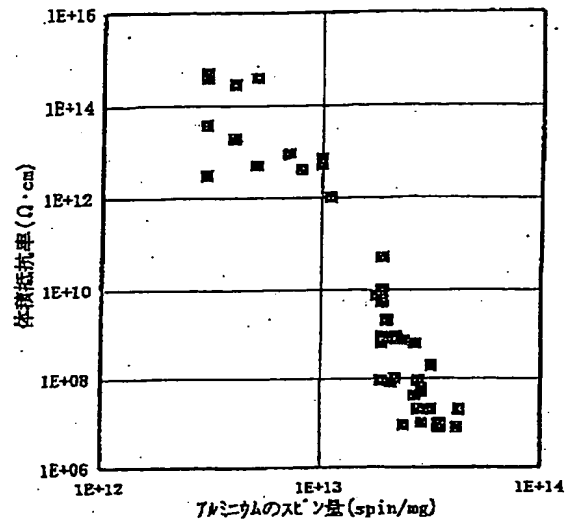
【符号の説明】

- 1 A、1 B、1 C 結晶粒子 2 界面 3 三重点
5 A、5 B 比較例の焼結体における結晶粒子 6
結晶粒子 5 Aと 5 Bとの界面 11 基体 14
誘電層 16 半導体ウエハー 19 電極
20 端子 21 抵抗発熱体

【図 5】



【図 6】

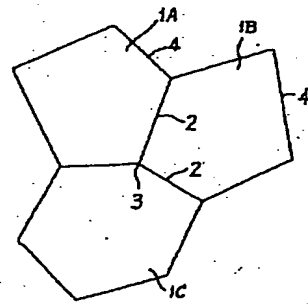


【図 7】

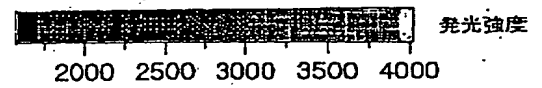
図面代用写真



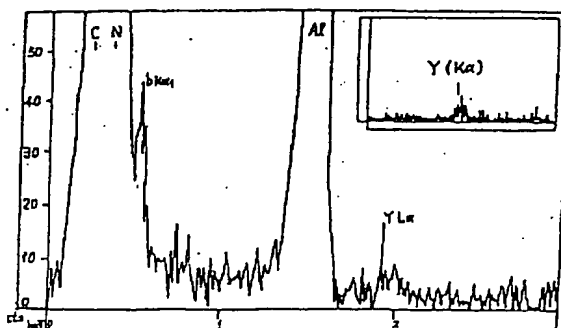
【図 2 1】



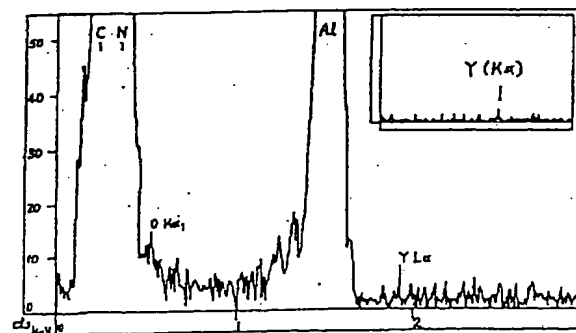
【図 2 7】



【図 1 0】

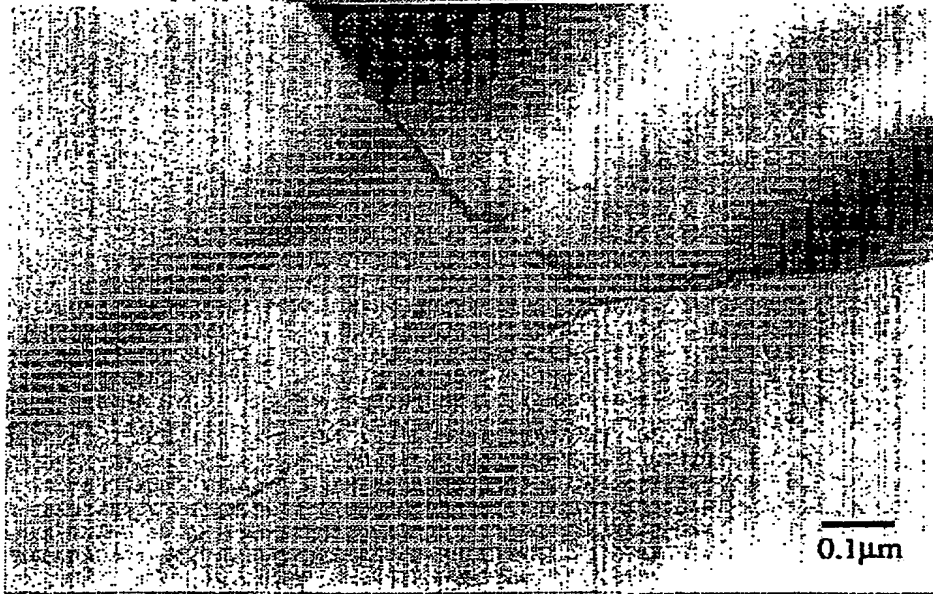


【図 1 1】



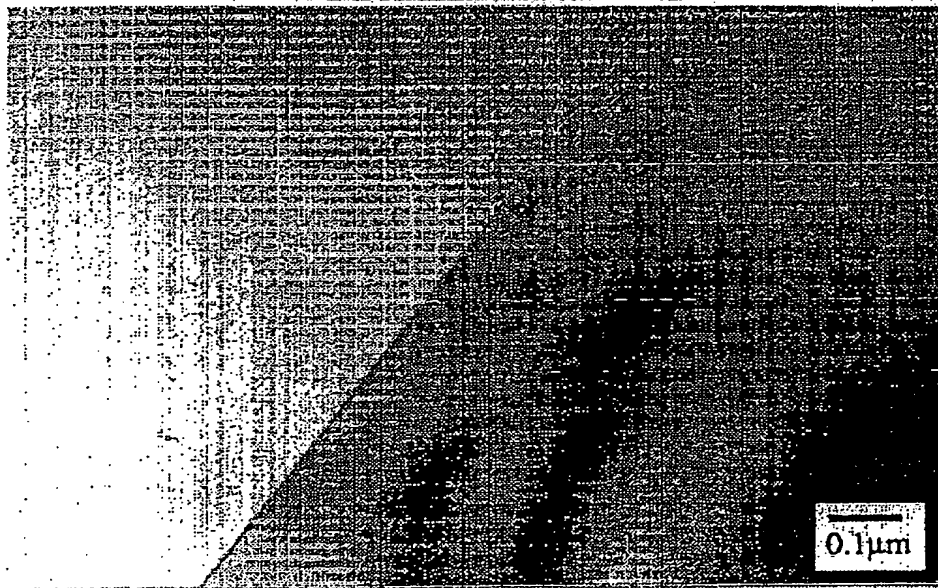
【図 8】

図面代用写真

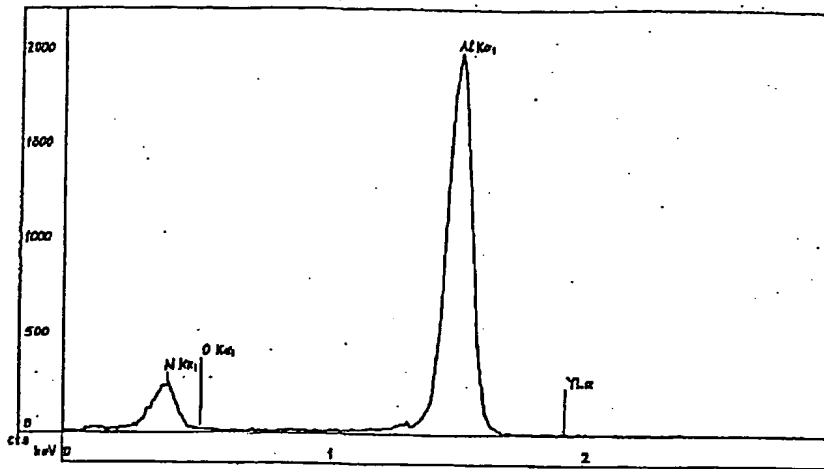


【図 9】

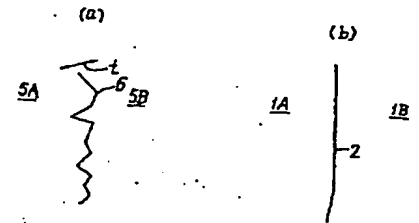
図面代用写真



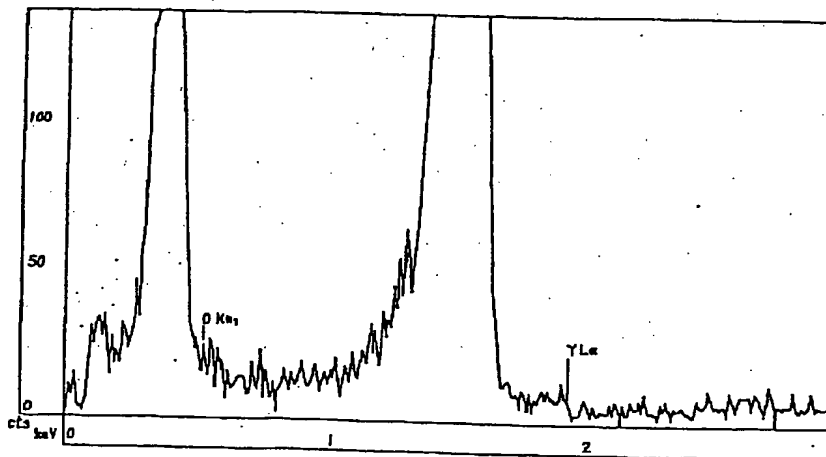
【図 1 2】



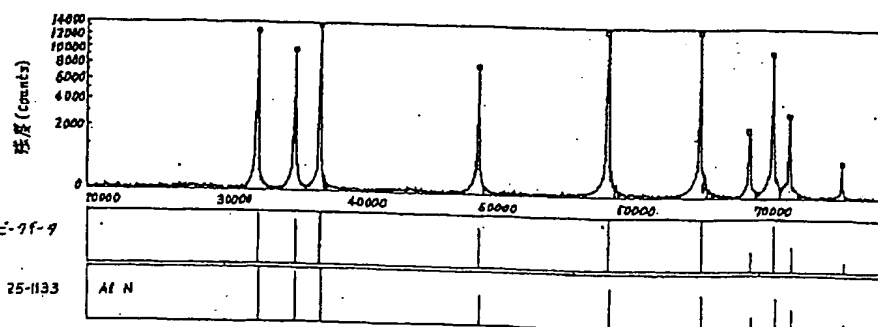
【図 2 2】



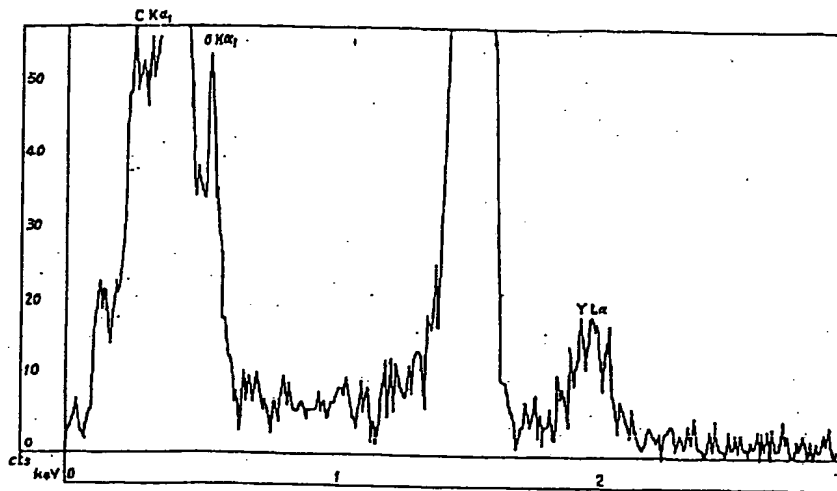
【図 1 3】



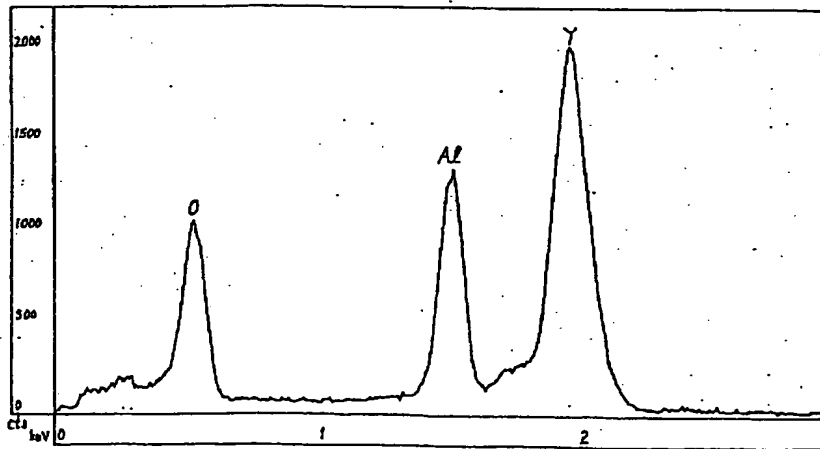
【図 1 6】



【図 14】



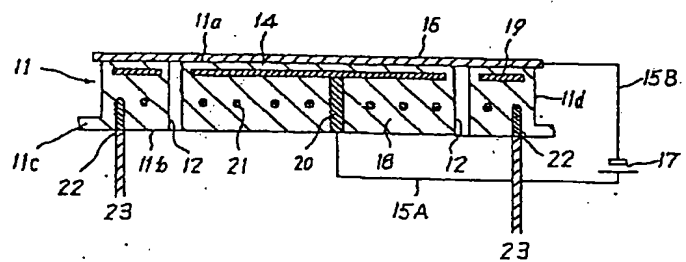
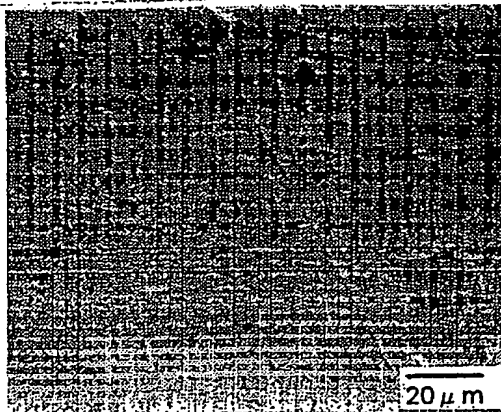
【図 15】



【図 28】

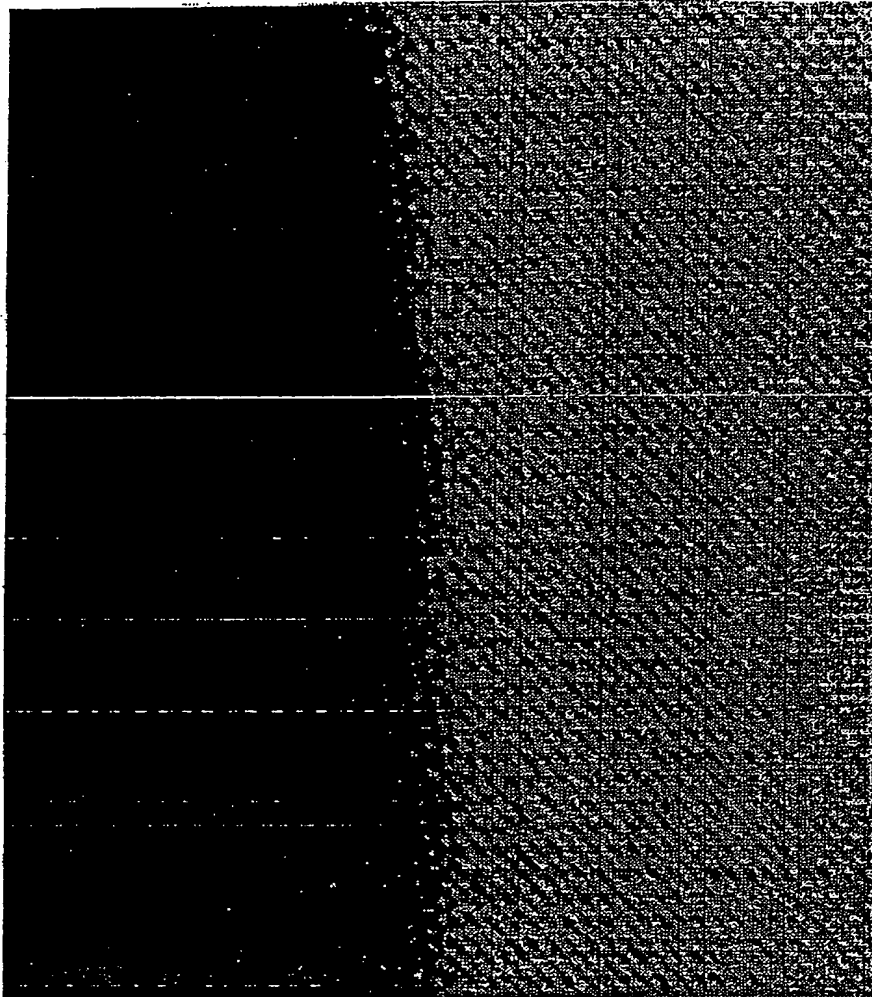
【図 29】

図面代用写真



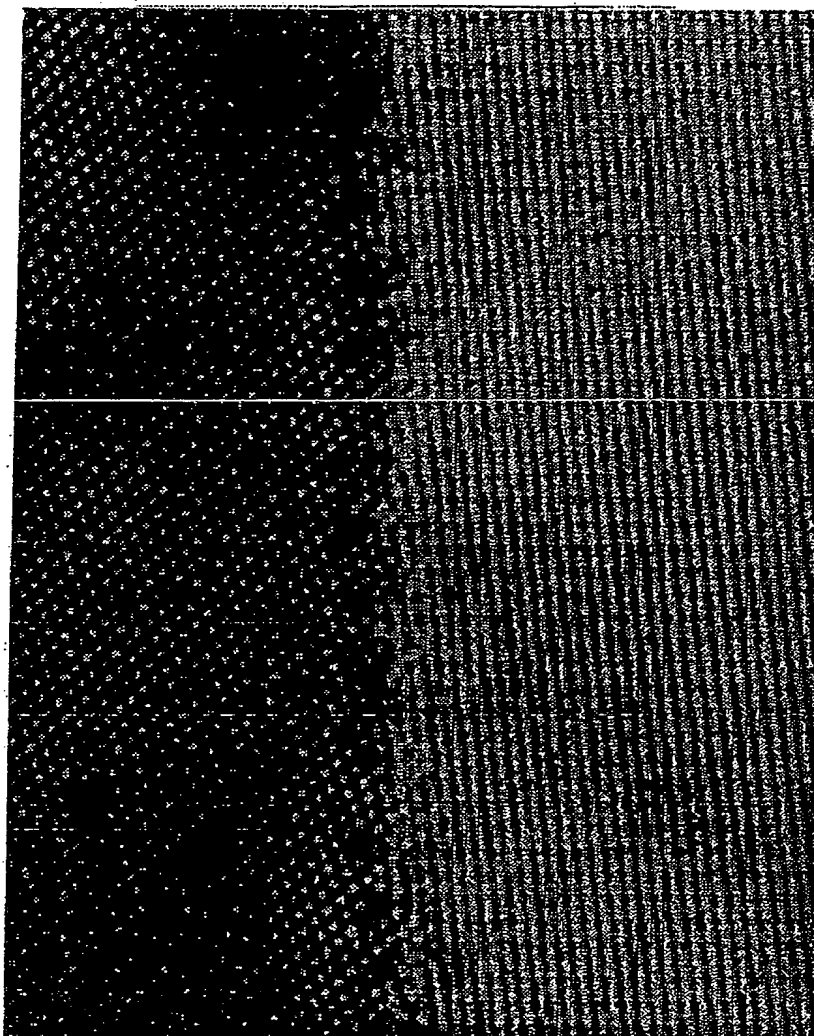
【図17】

図面代用写真



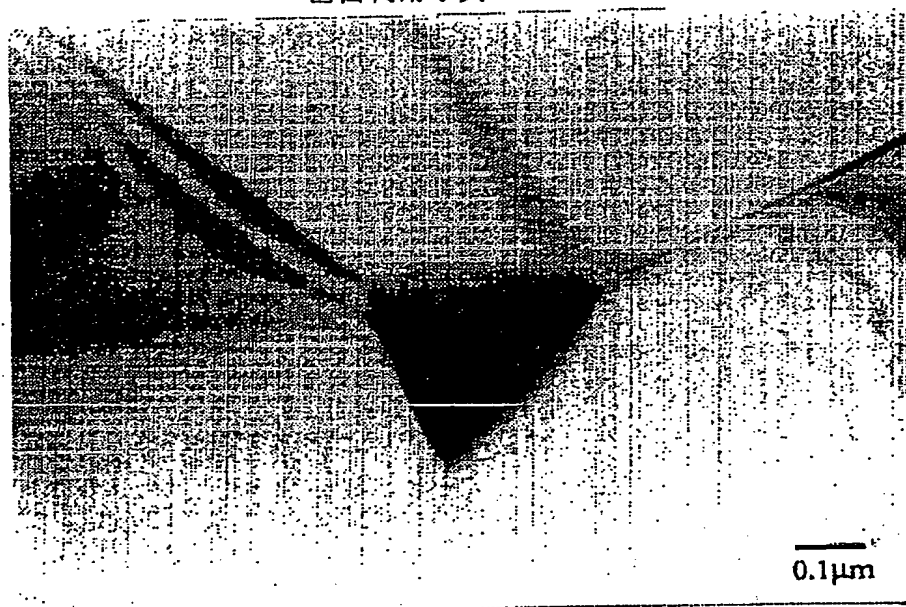
【図 18】

図面代用写真



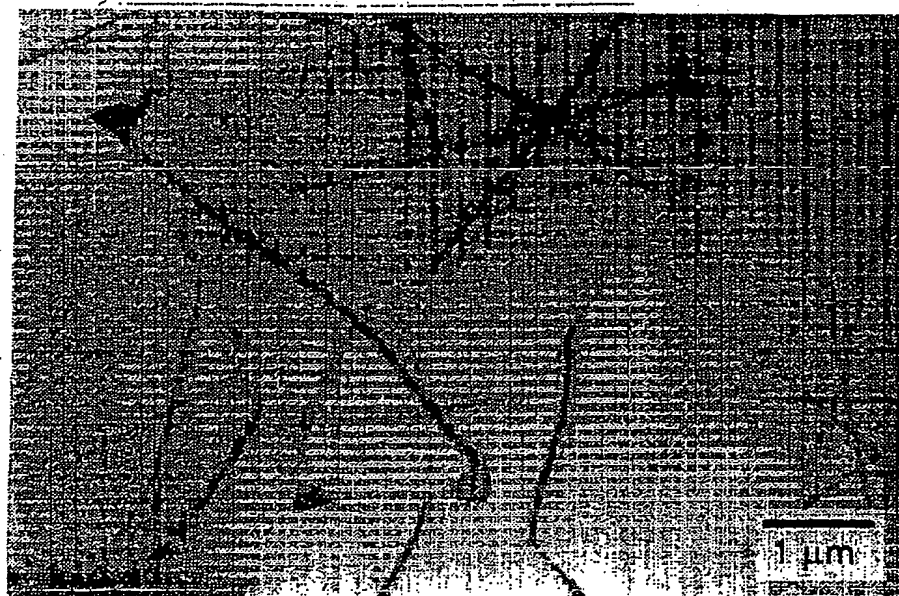
【図 1 9】

図面代用写真

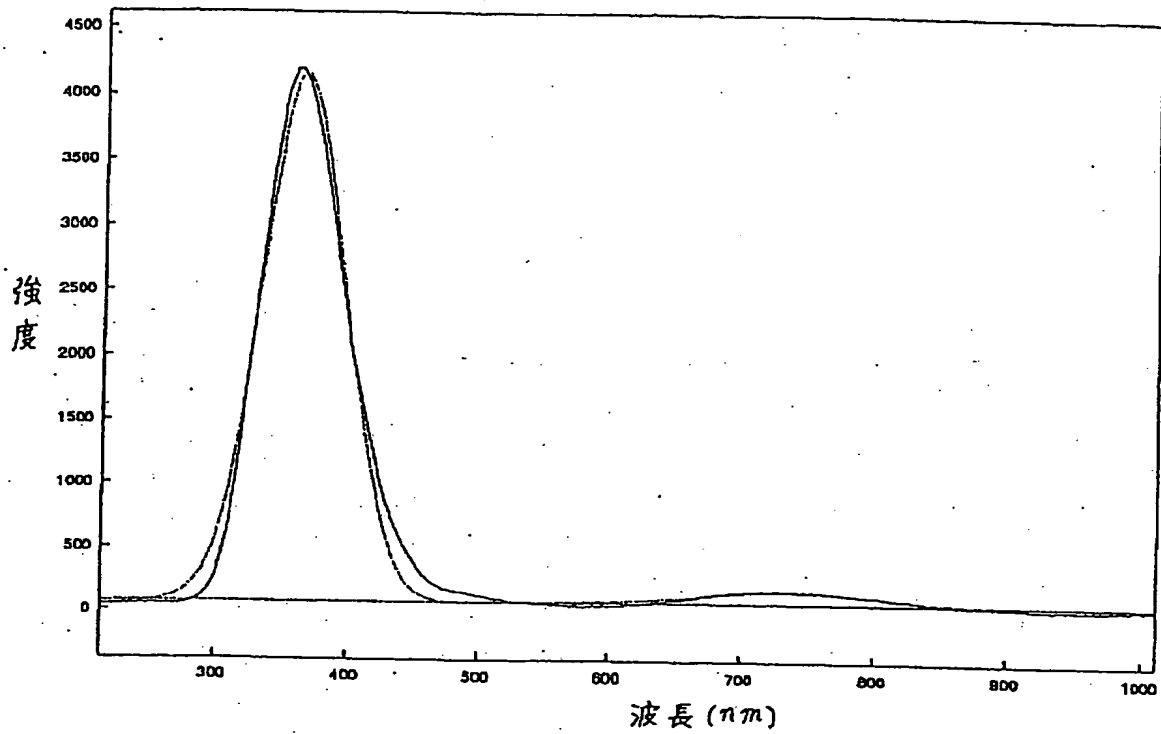


【図 2 0】

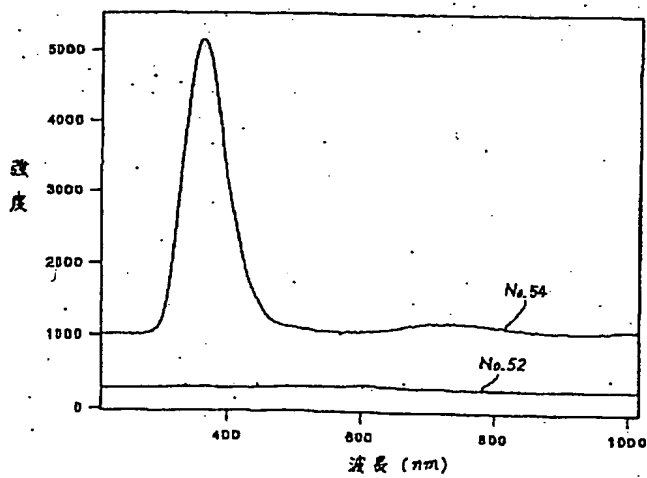
図面代用写真



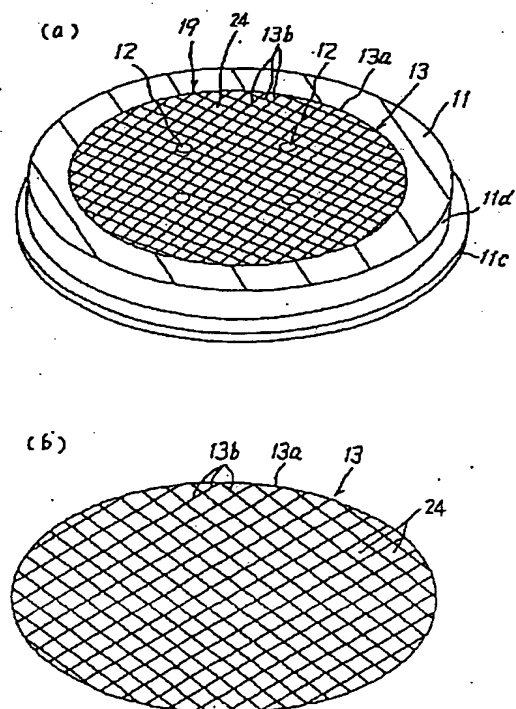
【図 23】



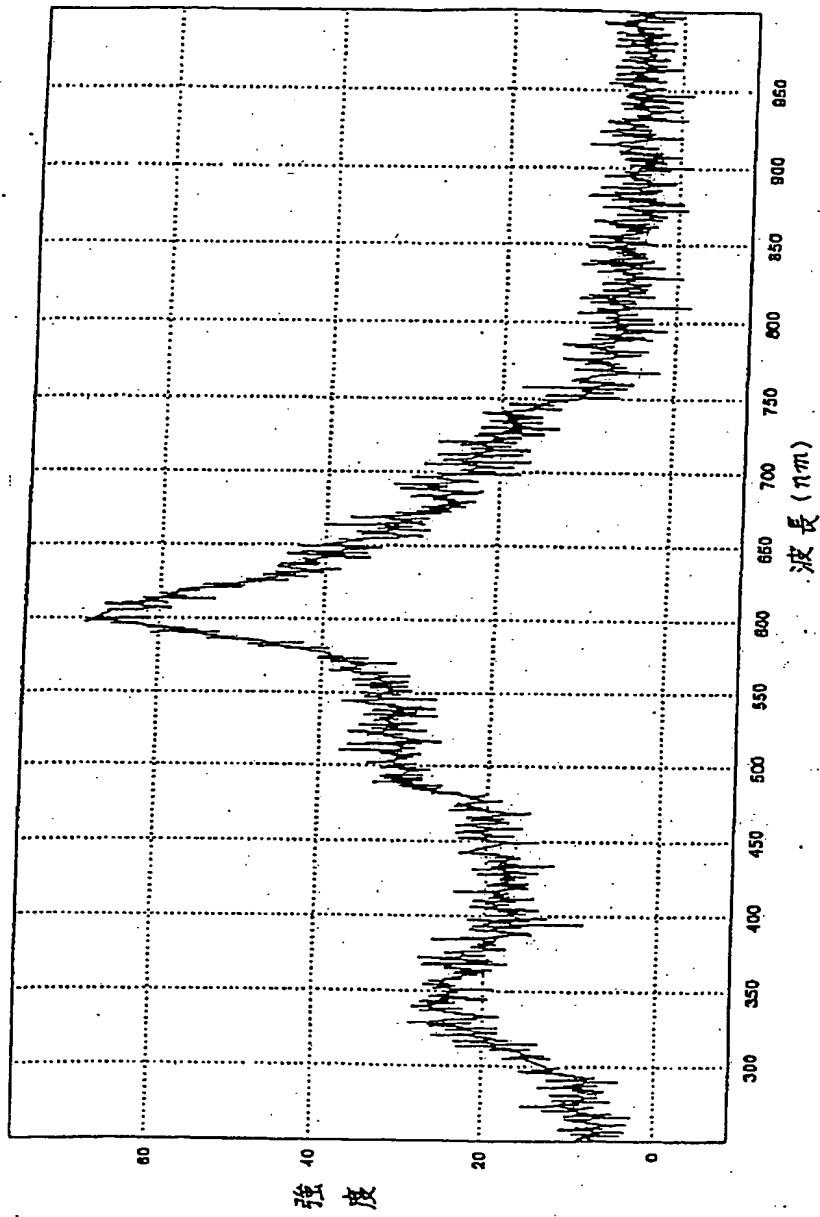
【図 25】



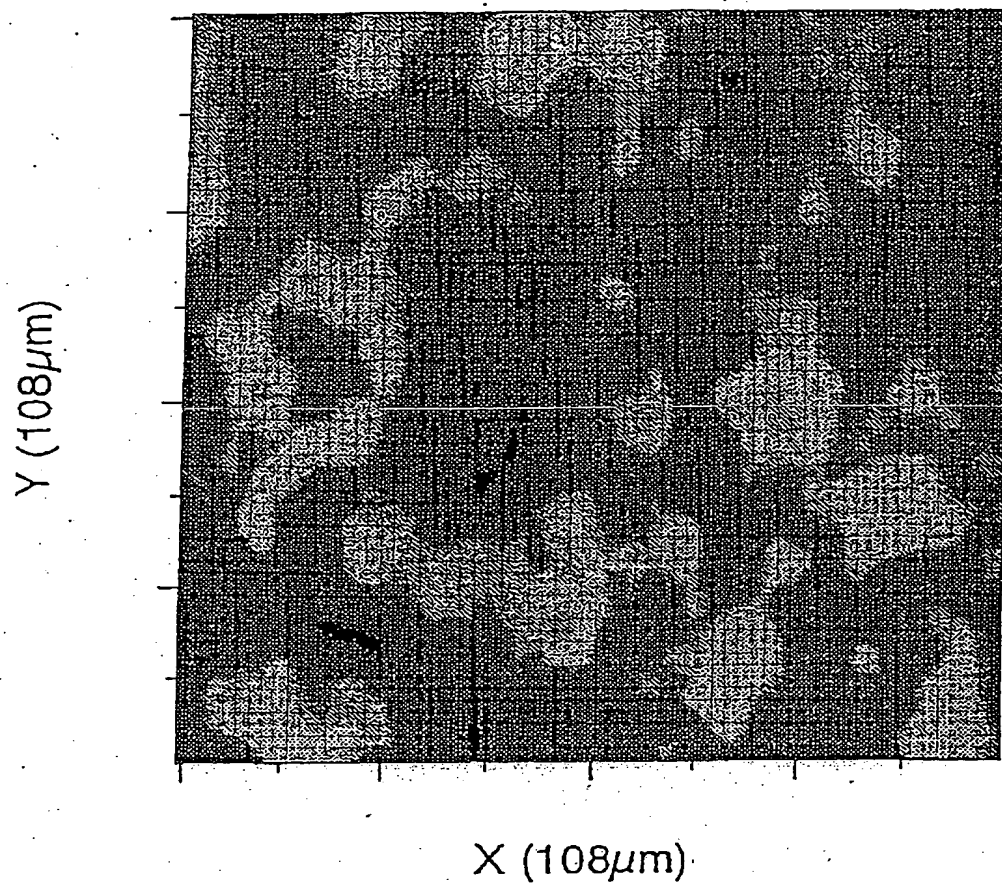
【図 30】



【図 2 4】



【図 2 6】



フロントページの続き

(72)発明者 高橋 道夫
愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 56 号 日
本碍子株式会社内